



دانشکده مهندسی هستهی و فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد نانو فیزیک

# سنتز ، مشخصه یابی و بررسی خواص فیزیگی

# نانوکامپوزیت های گرافن

نگارنده: **مهدیه مهرابی فر** 

استاد راهنما: دکتر محمد باقر رحمانی

شهریور ۱۳۹۸

#### دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده مهندسی هستهی و فیزیک

# گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه مهرابی فر به شماره دانشجویی ۹۵۱۴۶۶۴

تحت عنوان: سنتز ، مشخصه یابی و بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های گرافن

در تاریخ ...... توسیط کمیته تخصصی زیر جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مورد ارزیابی و با درجه ................ مورد پذیرش قرار گرفت.

امضاء	اساتید مشاور	امضاء	اساتيد راهنما
	نام و نام خانوادگی : ندارد		نام و نام خانوادگی : دکتر محمدباقر رحمانی

امضاء	نماینده تحصیلات تکمیلی	امضاء	اساتید داور
			نام و نام خانوادگی :
	نام و نام خانوادگی :		نام و نام خانوادگی :
			نام و نام خانوادگی :
			نام و نام خانوادگی :

تقديم اثر

صدای خنده ایتان به زندگانیم معنا می بخشد... میشه بخندید... با صدای بلند... آنفدر بلند که با دنبال کردن صدایتان، تنها در مسیر رضایت شا گام بردارم و به قلب مهربانتان برسم . . . ای کاش در لخطه وصال لایق برق شوق چنمانتان ماشم ... تفديم با حسرت بوسه بر دستان **بدر م** : به او که نمی دانم از بزرگواریش بکویم ما مردانگی ، سخاوت ، سکوت، مهربانی و... تفديم به **مادر** عزيزتر از جانم ، كه عاشق جثمان يرمحتش هتم . خواهر و برادرانم که همرایان همینکی و پیشوانه ای زندگیم بودند. مسلم برای بودنتان

تشکر و قدر دانی از اساد فرهیخه و عزیزم جناب آقای **دکتر محد ماقر رحانی** که در سایه توجهات ایشان و راههایی پهی سودمندشان توانشم گامی درجهت کسب علم و دانش بردارم کل تشکر را دارم. با اخترام فراوان از آقامان **مهندس عسکری و مهندس شهیدی** که دلسوزانه بمراهیم کردند سپاسکدار محبت ایتان خوابهم بود. در پایان از عزیز ترین دوست و همراهم شقایق فرضی کاهکش و کلیه دوستان مهربانم که ماد آوری خاطرانتان ماخوداگاه کنجندی بر چهرام می نشاند شکر می کنم . دوست دارم این کنجند بری سگاه را و برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می کنم . و ای معبود من ! باتمام وجودم، شکر کزار تمام نعمت کیت هشم .

# تعهد نامه

اینجانب مهدیه مهرابی فر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته نانو تکنولوژی گرایش نانو فیزیک، دانشکده مهندسی هستهی و فیزیک صنعتی شاهرود، نویسنده پایاننامه سنتز ، مشخصه یابی و بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های گرافن تحت راهنمایی جناب آقای دکتر محمد باقر رحمانی متعهد میشوم:

- تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت بر خوردار است.
  - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
- مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه صنعتی شاهرود» و یا
  Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایاننامه تأثیرگذار بودهاند در مقالات مستخرج از پایاننامه رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول
  اخلاقی رعایت شده است.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است
  اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.

تاريخ

امضاي دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده است) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.



دی کالکوژن های دوبعدی عناصر واسطه (2D TMD)، یک گروه از مواد با فرمول عمومی MX<sub>2</sub> می باشند که شامل بیش از ۴۰ ترکیب هستند. ، ترکیبات MX2 در فرم حجیم ساختارهای لایهای دارند (جامدات واندروالسی) که در آن ها پیوندهای لایهای محکم و پیوندهای بین لایهای ضعیف است. پس از سنتز موفقیت آمیز گرافن، تحقیقات گسترده ای در زمینهی مواد دو بعدی انجام گرفت. در این پایان نامه اکسید گرافن، اکسید گرافن کاهش یافته حرارتی، اکسید گرافن کاهش یافته شیمیایی و نانوکامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با سولفید مولیبدن سنتز و مشخصهیابی شدند و خواص حسگری گازی آنها مورد بررسی قرار گرفت. ویژگیهای ساختاری، ترکیب عنصری، ریختشناسی سطحی نمونههای سنتز شده به ترتیب با روشهای آنالیز XRD، FE-SEM، EDAX ،RAMAN ،FT-IR و UV-Vis مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از پودر گرافیت و پتاسیم پرمنگنات (KMnO4) اکسید گرافن (GO) به روش شیمیایی هامرز بهبود یافته تولید شد. اکسیدگرافن از شکستن پیوندهای ضعیف واندروالسی بین لایههای دو بعدی گرافیت حاصل میشود. در این فرآیند گروههای عاملی بین صفحات ایجاد می شوند. برای کاهش اکسید گرافن از کاهش حرارتی در دو دمای ۳۰۰ و  $^{\circ}$  ۹۰۰ و کاهش شیمیایی استفاده شد. در نهایت نمونه کاهش یافته با روش حرارتی با استفاده از روش مایکروویو بهبود داده شد. همچنین کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با سولفید مولیبدن با استفاده از روش هیدرترمال تهیه شد. در آنالیز رامان تغییرات نسبت شدت پیکهای دوقلو RGO نسبت به GO نشان دهندهی کاهش موفقیت آمیز و عالی این روش است. نتایج طیف سنج مادون قرمز نشان دهندهی کاهش شدت قلههای گروههای اکسیژندار و انجام فرآیند اکسایش است. تصاویر میکروسکوپی نمونهها نیز ساختاری دو بعدی از ورقههای مچاله شده RGO و نانوگلهای دی سولفید مولیبدن را نشان میدهد. حسگری کامپوزیت سنتز شده در دمای اتاق و  $^{\circ}$  ۱۰۰ نسبت به حسگری اکسید گرافن کاهش یافته حساسیت بهتری از خود نشان داد.

**کلمات کلیدی:** روش هامرز، اکسید گرافن کاهش یافته، نانو کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته/دی سولفید مولیبدن، حسگری گازی

مقالات التخراج شده

مهرابی فر، مهدیه، رحمانی، محمد باقر، (۱۳۹۸)، "سنتز و مشخصه یابی اکسیدگرافن کاهش
 یافته به روش ماکرویوو و بررسی اثر دما بر کاهش "،کنفرانس فیزیک، دانشگاه تبریز

فرست مطالب

د	تقديم اثر
1	فصل اول مقدمه
۲	۱–۱– مقدمه
۲	۲-۱- کربن
۴	۱-۳- از گرافیت تا گرافن
۴	۱-۳-۱ گرافن
۵	۱-۳-۲ گرافیت و اکسید گرافن
۶	۱-۳-۳ اکسیدگرافن کاهش یافته
۷	۱-۳-۴ کاهش اکسیدگرافن
λ	۱–۴– روشهای سنتز
۹	۱-۵- کامپوزیتھا
۱۰	۱-۶- ویژگیها و کاربردها
ی یافته وکامپوزیتهای آن	۱-۶-۱ حسگر گازی اکسید گرافن کاهش
۱۳	۱ – ۷ – جمع بندی

۱۵	فصل دوم مروری بر مقالات
١۶	۱-۲– مقدمه
١۶	۲-۲- سنتز اکسید گرافن به روش هامرز
۱۷	۲-۳- سنتز مشخصهیابی اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته
۲۰	۲-۴- کاهش حرارتی از اکسید گرافن ورقهای
۲۳	۲-۵- کاهش شیمیایی اکسید گرافن برای حسگری گاز آمونیاک در دمای اتاق
۲۵.	۲-۶- روش دو مرحله ای هیدروترمال جهت تهیه نانو کامپوزیت
۲۸	۲- ۲ سنتز لایههای فعال دو بعدی از هیبرید MoS <sub>2</sub> – RGO
٣٠	۸ -۲ سنتز نانو کامپوزیتهای MoS2 - RGO برای حسگری هیدروژن
۳۲	۹ – ۹ – جمع بندی
۳۳.	فصل سوم روشهای سنتز و مشخصه یابی
۳۴	۲–۱– مقدمه
۳۴	۲-۳- روش آب-گرمایی
۳۵	۳-۳- میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدانی (FESEM)
۳۶	۴-۳- پراش پرتو X
٣٩	۵-۳- طیف نگار نوری UV-Vis
۴۰	۳-۷- طیف سنجی تبدیل فوریهی فروسرخ
۴۳	۳-۸- رامان

۴۳	۳-۹- حسگری گاز
۴۷	۴-۹- جمعبندی
49	فصل چهارم نتایج تجربی وبحث
۵۰	۱-۴- مقدمه
۵۰	۴-۲- سنتز اکسید گرافن با استفاده از روش هامرز بهبود یافته
۵۳	۴-۶- مشخصه یابی اکسید گرافن
۵۳	۴–۶–۱– طیف نگار تبدیل فوریه مادون قرمز
۵۴	۴-۶-۲ طیف نگار رامان اکسید گرافن
۵۵	۴-۶-۳ ویژگی های اپتیکی طیف جذب UV-vis
۵۶	۴-۶-۴- الگوی پراش پرتو ایکس
۵۷	۴-۶-۵- ریخت شناسی اکسید گرافن
۵۸	۴-۶-۴ طیف نگار EDX
ر دما و بهبود	۴–۳- سنتز اکسید گرافن کاهش یافته (RGO) با روش حرارتی و بررسی تاثیر
۵۹	كاهش با مايكرويوو
۶۱	۴-۴- مشخصهیابی اکسید گرافن کاهش یافته به روش حرارتی
۶۱	۴-۴-۱- طیف نگار تبدیل فوریه مادون قرمز
۶۲	۴-۷-۲ طیف سنج رامان
۶۳	۲-۷-۴ ویژگی های اپتیکی UV-vis

94	۴-۷-۴ تحلیل پراش پرتو ایکس
99	۴-۷-۴ ریخت شناسی
۶٩	۲-۴- ۹- طیف نگار EDX
۶٩	۴-۷-۴ اندازه گیری جریان ولتاژ (I-V)
٧٠	۴–۵– ساخت نمونه حسگری
۷١	۴–۵–۱– حسگری گازی
۷۴	۴-۶- سنتز اکسید گرافن کاهش یافته با روش شیمیایی
٧۶	۴-۷- مشخصه یابی اکسید گرافن کاهش یافته به روش شیمیایی
٧۶	۴-۷-۱- طیف نگار مادون قرمز
۷۶	۴-۷-۲-طیف سنج رامان اکسید گرافن کاهش یافته با روش شیمیایی
۷۸	۴-۷-۳ ویژگی اپتیکی الگوی مادون قرمز UVUV
۷٩	۴-۷-۴ الگوی پراش پرتو ایکس
۷٩	۴–۷–۵ ریخت شناسی
٨٠	۴-۷-۴- طيف نگار EDX
۸۱	۴-۸- سنتز کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دی سولفید مولیبدن
٨٢	۴-۹- مشخصهیابی کامپوزیت اکسید گرافن کاهش با دیسولفید مولیبدن
۸٢	۴-۹-۱- طيف نگار رامان كامپوزيت ( RGO - MoS2)
٨۴	۴-۹-۳- ویژگی های اپتیکی UV-vis کامپوزیت RGO - MoS2

کاهش یافته با دی سولفید مولیبدن ۸۵	۴–۹–۵- ریخت شناسی کامپوزیت اکسید گرافن
٨۶	۴-۸- طیف نگار EDX
٨۶	۹-۴- حسگری گازی RGO – MoS2
٨٩	۴–۹– جمعبندی
۹۱	فصل پنجم نتايج وپيشنهادات
۹۲	۵-۱- نتیجه گیری
۹۳	۲-۵- پیشنهادات
۹۵	مراجع:

فهرست شكل كح

۴	شکل ۱–۱ : نانو ساختارهای کربنی بر طبق هیبریداسیون
	شکل ۱ –۲ : ساختار لایهای گرافیت شامل پیوندهای محکم اتمهای کربن با هیبرید SP2 در حلقههای شش
۵	ضلعی
۷	شکل ۱-۳ : شماتیکی از ساختار اکسید گرافن
٨	شکل ۱ – ۴ : روش سنتز اکسید گرافن کاهش یافته از اکسایش گرافیت
٩	شکل ۱–۵ : روشهای سنتز گرافن
١٢	شکل۱-۶ : تقسیم بندی حسگرها بر اساس نوع نیمرساناها
۱۸	شكل ۲-۱ : طيف جذب اكسيد گرافن و اكسيد گرافن كاهش يافته
۱۹	شکل ۲ – ۲ :طیف نگاری مادون قرمز اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته
۲۰	شكل ۲ – ۳ : الگويي پراش پرتو ايكس اكسيد گرافن واكسيد گرافن كاهش يافته
۲۱	شکل ۲ – ۴ : الگوی پراش پرتو ایکس نمونهها اکسید گرافن و گرافیت
۲۲	شکل ۲ – ۵ : تصاویر میکروسکوپی الکترونی نمونه ها
۲۳	شکل ۲ - ۶ : طیف جذب نمونههای GO با RGO
۲۴	شکل ۲- ۷ : حسگری گازی نمونه اکسید گرافن کاهش یافته برای غلظتهای مختلف گاز هدف آمونیاک
۲۴	شكل ۲ – ۸ :تغييرات حساسيت متناسب افزايش غلظت
۲۵	شکل ۲ – ۹: مقایسه پاسخ های ترکیبات آلی مختلف برای نمونهی حسگری
۲۶	شکل ۲ – ۱۰ : طرحوارهای از سنتز کامپوزیت MoS2 / RGO @ PANI
۲۷	شكل MoS2 / RGO ،PANI و MoS2 / RGO @ PANI
۲۷	شكل ۲ – ۱۲ : الگوى پراش پرتو ايكس پلى آنيلين و نانو كامپوزيت
۲۸	شکل ۲ – ۱۳ : الگویی از سنتز نانو کامپوزیت MoS₂ – RGO

۲٩	شكل ۲ – ۱۴ : الگوى پراش ايكس كامپوزيت MoS <sub>2</sub> – RGO
۳۰	شکل ۲ – ۱۵: الگویی از سنتز اکسید گرافن با استفاده از روش هامرز بهبود یافته و تهیه نانو کامپوزیت
۳۱	شکل ۲ – ۱۶: حسگری نمونهها را برای دو غلظت در دماهای مختلف
۳۱	شکل ۲ –۱۷ : پاسخ حساسیت کامپوزیت مبتنی بر نانوذرات RGO / MoS2 در دمای ۶۰C برای ۲۰۰ppm و ۵۰۰ppm برای گاز های H2، NO و NH3
ين ۳۶	شکل ۳-۱ : میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل از میدان مدلFESEM; Hitschi S-416 مورد استفاده شده در ا پایان نامه
۳۸	شکل ۲ – ۳ :پراش پرتوX از سطح یک بلور
ستفاده ۳۹	شکل ۳ – ۳ : دستگاه آنالیز پراش پرتو ایکس دامغان مدلBroker D8-Avance((Cu Kα1(λ=0.15406)) مورد ا در این پایان نامه
۴۰	شکل ۳ –۴ :دستگاه مدل Shimadzu uv- vis.1800 استفاده شده دز این پایان
۴۲	شکل ۳-۴ : دستگاه تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR مدل Rayleigh کشور چین مورد استفاده در این پایان نامه
۴۳	شکل ۳-۵ : دستگاه میکرو رامان مدل Raman-532-Ci با طول موج nm۵۳۲ استفاده شده در این پایان نامه
¥¥	شکل ۳-۶ : شماتیکی از حسگر گازی
خامت ۴۵	شکل ۳-۷: طرحی از خمش نوار ،که انرژی نوار رسانش (Ec)، انرژی نوار ظرفیت(Ev)، انرژی تراز فرمی (Ef)، ضخ لایه بار(Δ) و eV نشان دهندهی سد پتانسیل است
۴٩	شکل ۳–۸ : دستگاه دست ساز حسگری گازی دانشگاه صنعتی شاهرود استفاده شده در این پایان نامه
۵۲	شکل ۴-۱ : طرحوارهای از تهیه اکسید گرافن (GO) با روش هامرز بهبود یافته در این پایان نامه
۵۳	شکل ۴ –۲: طیف مادون قرمز نمونه GO تهیه شده با استفاده از روش هامرز
۵۴	شکل۴-۳: طیف رامان (GO) تهیه شد با روش هامرز بهبود یافته در این پایان نامه
۵۵	شکل ۴ – ۴: طیف جذب نمونه GO تهیه شده با استفاده از روش هامرز
۵۷	شکل ۴–۵- الگویی پراش پرتو ایکس (الف) پودر گرافیت (ب) اکسید گرافن تهیه شده با روش هامرز

۵۸	شکل ۴ – ۶ : تصاویرریخت شناسی نمونه GOدرمقایسهای الف)۵۰۰m ب)۵۰۰m ج)۵۰۰ m
۵۹	شكل ۴-۷ : الگویی EDAX نمونهGO
تلف ۳۰۰ و 	شکل ۴- ۸ – الگویی از مراحل سنتز اکسید گرافن کاهش یافته(RGO) با روش حرارتی در دو دمای مخ ۹۰۰۰°C و بهبود کاهش با ماکرویوو
۶۱	شکل ۴- ۹ : الگوی طیف نگار نمونههای الف)GO ب)Mw-RGO900 ج)MwRGO300 ج)
۶۳	شکل ۴- ۱۰ : مقایسه طیف رامان نمونه های اکسید گرافن با اکسید گرافن کاهش یافته به روش حرارتی
۶۴	شکل ۴- ۱۱ : طیف جذب نمونههای GO و GO MW – RGO و MW – RGO سو 300 MW – MW
۶۵	شکل ۴ – ۱۲ : الگوی پراش پرتو ایکس برای نمونه های  Mw – RGO 300 و Mw – RGO و 900 – Mw
ی الف) μm1 ۶۷	شکل ۴ –۱۳ : تصاویر ریخت شناسی نمونه 300 Mw – RGO تصاویر ریخت شناسی نمونه GO در مقایسهای ب)100 ج) 100 nm د)nm500
ل الف) ۱μm ۶۸	شکل ۴ – ۱۴ : تصاویر ریخت شناسی نمونه Mw – RGO 900 تصاویر ریخت شناسی نمونه GO در مقایسهای ب)۰۰ mm ج)۰۰ nm د)۰۰ ۱۰۰ د)۵۰۰m
۶۹	شكل ۴ – ۱۵: آناليز EDAX نمونهى الف) MW-RGO 300 و ب) MW-RGO 900
۷۰	شكل ۴- ۱۶ : نمودار جريان – ولتاژ نمونه MW-RGO 300 و MW-RGO 900
۷۱	شکل ۴-۱۷: طرحواره ی از نمونه حسگری ساخته شده
۷۲	شکل۴ – ۱۸ : نمودار حسگری گازی برای نمونه Mw – RGO 900 در دمای ۲۰۰°C
۷۳	شکل۴ — ۱۹ : نمودار حسگری گازی برای نمونه Mw – RGO 900 در دمای اتاق
, ب) دمای ۷۴	شکل ۷- ۲۰ : نمودار تغییرلت حساسیت با افزایش غلظت نمونه Mw – RGO 900 الف) در دمای اتاق ۱۰۰C°
۷۵	شکل ۴- ۲۱ – طرحوارهی از مراحل تهیه اکسید گرافن کاهش یافته با روش شیمیایی در این پایان نامه
٧۶	شکل ۴ – ۲۲ : طیف نگار مادون قرمز RGO – H
۷۷	شکل ۴ – ۲۲ : طیف نگار رامان RGO – H
۷۸	شکل ۴ – ۲۴ : طیف مادون قرمز   RGO – H

٧٩	شکل ۴ – ۲۵ :پراش پرتو ایکس اکسید گرافن کاهش یاقته به روش شیمیایی
مونه GO در مقایسهای الف)۲µm ۸۰	شکل ۴ –۲۶ : تصاویر ریخت شناسی نمونه RGO - H تصاویر ریخت شناسی ن ب)mm ج)۲۰۰ mm د) ۲۰۰ د)۵۰۰m
۸۱	شکل ۴-۲۷ : آنالیز EDAX نمونهی RGO – H سنتز شده در این پایان نامه
سولفید مولیبدن با استفاده از روش ۸۲	شکل ۴ -۲۸ : طرحوارهی از سنتز کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دی، هیدرترمال در این پایان نامه
ر این پایان نامه با استفاده از روش. ۸۳	شکل ۴- ۲۹ : الگوی طیف رامان نمونهی کامپوزیت RGO - MoS2 سنتز شده د هیدروترمال
MW - RGO(۴ RGO – MoS2 (۳ λδ	شکل ۴ - ۳۰ : طیف جذب نمونههای مختلف سنتز شده ۱) RGO - H (۲ GO (۱) شکل ۴ - ۳۵ : MW – RGO 900 (۵ 300
۲۰۰ n و ۲۰۰ م.	شکل ۴-۳۱ : ریخت شناسی نمونه RGO - MoS2 در مقیاس ۳، ۲µm
٨۶	شکل ۴- ۳۲ : آنالیز EDAX نمونهیRGO - MoS2 سنتز شده با روش هیدروترمال.
تز شده نسبت به گاز NH3 در دمای ۸۷	شکل ۴ -۳۳ : نمودار تغییرات مقاومت برحسب زمان نمونهی RGO – MOS2 سن اتاق برای غلظتهای ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ppm
تز شده نسبت به گاز NH3 در دمای ۸۸	شکل ۴ -۳۴ : نمودار تغییرات مقاومت برحسب زمان نمونهی RGO – MOS2 سن ۱۰۰C برای غلظتهای ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ppm
ا الف) در دمای اتاق ب) در دمای م	شکل ۴-۳۵ : نمودار تغییرات حساسیت با افزایش غلظت نمونهی RGO - MoS2
Λ \	······································

فهرست جدول

ل ۱−۱: مواد مورد استفاده در تهیه نمونه	جدوز
۲−۴: گروههای اکسیژن دار ایجاد شده در GO تهیه شده باروش هامرز در این پایان نامه دار این بایان نامه	جدوا
ی ۴−۴: گروههاای اکسیژندار باقی مانده بروی صفحات گرافنی بعد از کاهش GO GV	جدوا
ر ۴ – ۴: مقایسه نسبت شدت قلههای اکسید گرافن با اکسید گرافن کاهش یافته با روش حرارتی در دو دمای ۳۰۰	<i>جدوا</i>
۶۳	و °C
ی ۴ −۵ : مقایسه فاصله صفحات نمونههای تهیه شده	جدول
. ۴ - ۶ : تغییرات مقاومت، حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه Mw − RGO 900 نسبت به غلظتهای مختلف	جدول
مونیاک در دمای حسگری C°۱۰۰۰	گاز آ،
ں ۴- ۲: تغییرات مقاومت، حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه Mw – RGO 900    نسبت به غلظتهای مختلف	جدول
مونیاک در دمای حسگری اتاق	گاز آ،
ں ۴-۸: نسبت شدت قله های نمونههایMW-RGO 300 و MW-RGO – H و MW-RGO – H و NW-RGO.	جدوز
٫ ۴ –۹ : تغییرات مقاومت، حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونهی RGO – MOS2 نسبت به غلظتهای مختلف	جدوز
NH3 در دمای اتاق	گاز 3

فنس اول

مقرمه

۱–۱ مقدمه

طی دهههای اخیر، توجه تحقیقات علمی در سرتاسر جهان به سمت مطالعه رفتار مواد در مقیاس نانو جلب شده است و در اکثر زمینههای علمی و مهندسی میتوان اثری از فناوری نانو یافت. هدف از علم نانو، طراحی و ساخت مواد نوین و کاربردی است. امروزه نانو علمی فراگیر است بهنحوی که شیمی-دانان، فیزیکدانان، پزشکان، مهندسان و طرفداران محیط زیست در جهت ارتقای جامعه از طریق علم نانو با یکدیگر همکاری میکنند.

در این فصل اتم کربن و آلتروپهای آن معرفی میشود. از بین آلتروپهای کربن گرافن به عنوان یک نیم رسانا با گاف نواری صفر و ویژگیهای منحصر به فرد مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس به فرآیند سنتز گرافن<sup>۱</sup> از گرافیت اشاره میشود. به صورت مختصر ویژگیها و کاربردهای اکسید گرافن کاهش یافته<sup>۲</sup> بررسی میشود. سپس کامپوزیتهای بر مبنای گرافن با سولفید مولیبدن<sup>۳</sup> و کاربرد این نانو مواد در حسگرهای گازی مورد مطالعه قرار گرفت.

# ۲-۱- کربن

کربن ششمین عنصر در جدول تناوبی است که توانایی ایجاد پیوندهای پایدار با دیگر اتمهای کربن، اکسیژن، نیتروژن، گوگرد و بسیاری از عناصر دیگر در جدول تناوبی مندلیف را دارا است. کربن یکی از فراوان ترین عناصر زمین است [۱].کربن در قالب بسیاری از آلوتروپها<sup>۴</sup> (ساختارها) وجود دارد، که می تواند براساس خصوصیت پیوند شیمیایی مرتبط با هیبریداسیون (sp<sup>3</sup> ،sp<sup>2</sup> ،sp<sup>1</sup>) طبقهبندی شوند. هر آلوتروپ ویژگیهای الکترونیکی و مکانیکی خاص خود را دارد [۱].

<sup>&</sup>lt;sup>\</sup> Graphen

 $<sup>^{</sup>r}$  Reduced graphene oxide

<sup>&</sup>quot; Molybdenum sulfide

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Allotropes



شکل ۱-۱: نانو ساختارهای کربنی بر طبق هیبریداسیون [۱]

برای مثال: گرافن دارای ساختار الکترونی نیمرسانایی و دارای تحرک الکتریکی فوق العاده بالا است، اما الماس عایق و یکی از سختترین مواد طبیعی است. از میان نانو ساختارهای کربن، آلتروپهای با هیبریداسیون sp<sup>3</sup> (مانند: الماس) و sp<sup>2</sup> (مانند: گرافیت، گرافن، فولرین، نانولولهها) به علت ویژگیهای منحصر بفرد، در فناوری مورد توجه قرار گرفته اند [۱].

# ۱-۳- از گرافیت تا گرافن

۱-۳-۱ گرافن

گرافن یک تک لایه از اتمهای کربن با هیبریداسیون sp<sup>2</sup> است که از پیوندهای کربن-کربن با طول ۳۸ ۲۰/۱۴۲ می به صورت سه پیوند کوولانسی محکم به یکدیگر متصل می شوند و یک شبکه بلوری با طرح دو بعدی شش ضلعی را تشکیل می دهند، به وجود آمده است[۲]. چهارمین الکترون کربن با ۱لکترون اتم کرین صفحهی مجاور پیوند ضعیف واندروالسی را تشکیل می دهد. همانطور که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است گرافیت دارای ساختار لایهی بلوری سه بعدی (۳D) است، که از روی هم قرار گرفتن ورق های گرافن دو بعدی (TD) ساخته شده است. لایه های گرافن در مجاور یکدیگر توسط نیروهای ضعیف واندروالسی با فاصله mm ۵۳/۰ از یکدیگر قرار گرفته اند. بنابراین در ورقه های گرافن زمانیکه اوربیتال های Pz به صورت موازی قرار گرفته باشند در سطح دارای کمترین انرژی اند و می توانند



شکل ۱ - ۲ : ساختار لایه ای گرافیت شامل پیوندهای محکم اتمهای کربن با هیبرید SP2 در

حلقەھاى شش ضلعى[٢]

گرافن یک نیمرسانا با گاف انرژی صفر است. حاملهای بار در گرافن مانند فرمیونهای بدون جرم رفتار میکنند بنابراین رفتار آنها با معادله دیراک<sup>۱</sup> بررسی میشود [۳]. همچنین ویژگیهای استثنایی حرارتی و نوری و الکتریکی گرافن نتیجهی جفت شدگی π-π آن است [۴].

تلاشهای فراوانی برای ساختن گرافن صورت گرفته است، سنتز گرافن اولین بار در سال ۲۰۰۴ بواسطه تحقیقات آندره ژیم<sup>۲</sup> و کنستانتین نوسلوف<sup>۳</sup> (برندگان جایزه نوبل فیزیک۲۰۱۰) از دانشگاه منچستر انجام شد آنها با استفاده از روش نوار اسکاچ در ویفر سیلیکون موفق به جداسازی یک ورق گرافن شدند. امروز گرافن موضوع پژوهشهای زیادی در جامعه علمی است و به دلیل ویژگیهای برجسته الکترونیکی، نوری، حرارتی و مکانیکی در بسیاری از کاربردهای صنعتی میتوان از آن استفاده

#### ۱-۳-۲ گرافیت و اکسید گرافن

اطلاع از ساختار اکسید گرافیت قبل و بعد از هر گونه اصلاح شیمیایی بسیار مهم است. اکسید گرافیت عمدتا از اتمهای کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. برای اکسیدهای گرافیت معمولا نسبت کربن به اکسیژن حدود ۱/۵ تا ۲/۵ است. روش سنتز اکسید گرافیت حدود ۱۵۰ سال پیش شناخته شده است [۵]. بر اساس مدل لرف کلینوسکی<sup>۴</sup> از اکسید گرافیت، که به طور گسترده پذیرفته شده است. روی سطح صفحات اکسید گرافیت پیوندهای اکسیژندار هیدروکسیلها<sup>۵</sup> و اپوکسیدهای<sup><sup>9</sup></sup> بسیار زیادی وجود دارد در حالی که لبه صفحات به طور عمده شامل پیوندهای اکسیژنداری کربوکسیل<sup>۷</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>\</sup> Dirac

 $<sup>{}^{\</sup>scriptscriptstyle \Upsilon}$  Sir Andre Konstantin Geim

<sup>&</sup>lt;sup>к</sup> Константи́н Серге́евич Новосёлов

<sup>\*</sup> Lerf-Klinowski

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Hydroxyls

<sup>&</sup>lt;sup>¢</sup> Epoxides

 $<sup>^{\</sup>nu}$  Carboxyl

و کربونیل<sup>۱</sup> و غیره است. پیوندهای اکسیژندار ایجاد شده در ساختار گرافیت نشاندهندهی موفقیت آمیز بودن تهیه اکسید گرافیت است. در فرآیند تهیه گرافن اکسیژنهای وارد شده در ساختار به صورت کامل حدف نمی شوند و نقایص ساختاری محسوب می شوند و به همین علت از تشکیل گرافن با کیفیت جلوگیری میکنند [۵].



شکل ۱-۳ : شماتیکی از ساختار اکسید گرافن [۲]

اکسید گرافن<sup>۲</sup> (GO) شکل لایهای اکسید گرافیت، به عنوان یکی دیگر از واسطههای مهم دیده شده بین گرافیت و گرافن است. ساختار اکسید گرافن متفاوت ولی از لحاظ شیمیایی شبیه به اکسید گرافیت است. شکل ۱-۳ ساختار اکسید گرافن رانشان میدهد.

#### ۱-۳-۳ اکسیدگرافن کاهشیافته

برای تبدیل اکسید گرافن به گرافن از روشهای کاهشی کاهشی از قبیل: حرارتی، الکتروشیمیایی، شیمیایی، مایکروویو استفاده میشود. روشهای کاهش مبتنی بر حذف پیوندهای اکسیژن دار در گرافیت / اکسید گرافیت است. روشهای مختلف تولید گرافن، منجر به تفاوت ویژگیهای الکترونی و ریخت-شناسی سطح محصول میشود[۵].

<sup>&</sup>lt;sup>\</sup> Carbonyl

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> Graphene oxide

کاهش محتوای عنصر اکسیژن با افزایش نسبت O / O که نشان دهنده ی افزایش هدایت جریان الکتریکی و بالا بردن کارایی اکسید گرافن کاهش یافته (RGO) است بیان می شود. این ماده شبه گرافنی شامل ورقهای ناقص شبکه کربنی sp<sup>2</sup> است اما شباهت زیادی به ساختار گرافن دارد و بسیار پرکاربرد است [۵].

۱–۳–۴– کاهش اکسید گرافن

اکسید گرافیت برای اولین بار در ۱۵۰ سال قبل تهیه شد. حذف گروههای اکسیژن دار موجود در سطح اکسید گرافیت با استفاده از مواد شیمیایی بعد از حدود ۸۰ سال از تهیه اکسید گرافیت اتفاق افتاد. روشهای زیادی برای سنتز گرافن معرفی شدهاند. از میان آنها، کاهش شیمیایی اکسید گرافن (GO)، به عنوان یکی از روشهای امیدبخش در زمینه تولیدگرافن با هزینه کم در یک زمان کوتاه و در مقیاس زیاد برای کاربردهای تجاری است. تاکنون بیش از ۵۰ نوع از عاملهای کاهش دهنده شیمیایی اکسید گرافن معرفی شده است [۵ و ۶].



شکل ۱ - ۴ : روش سنتز اکسید گرافن کاهش یافته از اکسایش گرافیت[۵]

<sup>&</sup>lt;sup>\</sup> Reduced graphene oxide

H<sub>2</sub>S Hولین عامل کاهنده در سال ۱۹۳۴ شناخته شد و بعد از آن، تعداد زیادی از کاهندهها برای کاهش GO معرفی شدند از میان آنها، هیدرازین<sup>۱</sup> به عنوان کاهندهی RGO با قابلیت بهبود بخشیدن به خواص الکتریکی و ساختاری شبه گرافنی شناخته شده است. با این حال، کاهش با هیدرازین از مشکلات خاصی مانند ماهیت سمی بودن هیدرازین که برای محیط زیست و همچنین موجودات زنده مضر است برخوردار بود. محققان به دنبال عوامل جایگزین که برای محیط زیست و همچنین موجودات زنده مضر است با در این مشکلات خاصی مانند ماهیت سمی بودن هیدرازین که برای محیط زیست و همچنین موجودات زنده مضر است برخوردار بود. محققان به دنبال عوامل جایگزین که با کیفیت هیدرازین برابری کند بودند. این مشکلات سبب معرفی رویکرد «کاهش سبز» در این زمینه شده است [۶]. اولین عامل شناخته شده این مشکلات سبب معرفی رویکرد «کاهش سبز» در این زمینه شده است [۶]. اولین عامل شناخته شده سازگار با محیط زیست، اسید آسکوربیک<sup>۲</sup> (۲۰۱۰) ( یک اسید آلی غیر سمی و ارزان) میباشد که بهترین جایگزین برای هیدرازین سمی است[۱]. همچنین روش دیگری که منجر به تولید اکسید گرافن

#### ۱–۴– روشهای سنتز



گرافن به دو روش کلی از پایین به بالا و از بالا به پایین تولد می شود [۷].

<sup>\</sup> Hydrazine

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> Ascorbic acid

رویکرد پایین به بالا به دنبال ساخت صفحات گرافن از مولکولهای ساده کربن مانند متان و اتانول است. از سوی دیگر، رویکرد از بالا به پایین بر مبنای تولید لایه گرافن از گرافیت است. با این حال، از لحاظ عملکرد بالا و هزینه کم، رویکرد بالا به پایین از طریق اکسایش و کاهش شیمیایی، مناسبترین روش مطرح شده است.

علاوه بر این، گرافن به دست آمده از طریق کاهش شیمیایی برای بخش بزرگی از کاربردها مانند: سنسورها، کامپوزیتها، پوششها، لایههای رسانای شفاف، کاربرد زیستی و ذخیره انرژی و غیره بسیار مهم است. در حال حاضر طیف گستردهای از عوامل کاهشدهنده برای اکسیدگرافن در مقالات وجود دارد[۷].

# ۱-۵- کامپوزیت ها

دو روش برای ساخت نانوکامپوزیتهای برمبنای گرافن وجود دارد. در روش هیبریداسیون در حین واکنش مواد اولیه با یکدیگر ترکیب میشوند و نانو ذرات در حین فرآیند سنتز نانو کامپوزیت تشکیل میشوند. در روش بعدی مادههای به صورت مجزا تهیه میشوند و از ترکیب آنها با یکدیگر کامپوزیت تهیه میشوند [۹]. وجود گروهای عاملی بروی نانو صفحات GO و RGO باعث شده است که این مادهها به راحتی با سایر نانو مواد از جمله نانو ذرات، نانو لولههای کربنی، پلیمرهای هادی و غیره کامپوزیت تشکیل دهند و باعث بهبود خواص الکتریکی و حرارتی و مکانیکی در کامپوزیتهای برمبنای گرافن می گردند [۸].

نانو کامپوزیتهای بر مبنای گرافن کاربردهای زیادی در زمینههای مختلفی از جمله: حسگرها، بیوحسگرها، الکترودهای شفاف، ابررایانههای با انرژی بالا، سلولهای خورشیدی، میکروسیستمها، رساناهای قابل انعطاف و باتریهای یونی لیتیومی و غیره دارند [۸].

# ۱-۶- ویژگیها و کاربردها

گرافن در بین آلتروپهای مختلف کربن با توجه به ویزگیهای الکترونیکی، مکانیکی و حرارتی فوقالعاده خود مورد توجه خاصی قرار گرفته است. گرافن دارای مشخصات منحصر به فردی از جمله: ۵۰۰۰ و ۱۰ برابر بیشتر از مس )، شفافیت نور بالا ( تقریبا ۹۹/۷٪ )، مساحت سطحی بالا ( g<sup>-1</sup> ۲۶۳۰m<sup>2</sup> )، مدول یانگ<sup>۱</sup> بالا ( تقریبا ۱ Ta )، استحکام ذاتی ( GPa ۱۳۰ ) است. گرافن اخیرا در زمینه نانو الکترونیک تغییر و تحول چشمگیری ایجاد کرده است و سهم برجسته آن نه تنها در نانو الکترونیک، بلکه در علوم پزشکی، نانو و رباتیک نمایان است [۹]. حضور گروههای عاملی در لبه و دو طرف صفحات اکسید گرافن و مشتقات آن موجب حل شدن بهتر این ماده در آب و دیگر حلالهای آلی شده است. دارا بودن خاصیت آب دوستی اکسید گرافن باعث ایجاد پتانسیل زیادی در کاربردهایی از جمله تصویر برداری مولکولی شده است [۱۰]. همچنین اکسید گرافن به علت داشتن الکترونهای آزاد رسانایی دارای الکتریکی بسیار خوبی هستند. این ماده در ابزارهای الکتریکی، زیستی، داروسازی به دلیل دارابوددن بودن پیوند کوالانسی با بافتهای زنده بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۱۰]. هدایت الکتریکی گرافن مستقيما به كيفيت گرافن بستگي دارد. به عنوان مثال هرچه كيفيت گرافن بالاتر باشد چگالي عيوب شبکه کمتر و درنتیجه رسانای آن بیشتر میشود. بطور کلی عیوب بعنوان مکانهای پراکندگی عمل مي كنند و انتقال بار از طريق محدود شدن مسير آزاد ميانگين الكترون كاهش مي شود [١١].

## ۱.-۶-۱- حسگر گازی اکسید گرافن کاهش یافته وکامپوزیتهای آن

شناسایی نوع و میزان انواع گازها با دقت بالا و هزینه کم در محیط اطرافمان به ویژه گازهای آلاینده، خطرناک و زیست تخریب بسیار مورد اهمیت است. به برخی از این گازها از جمله اکسید

Young's modulus '

نیتروژن (NO)، دی اکسید نیتروژن (NO<sub>2</sub>)، منو اکسید کربن (CO)، دی اکسیدکربن(CO<sub>2</sub>)، سولفید هیدروژن (H<sub>2</sub>S)، دی اکسید سولفید (SO<sub>2</sub>)، آمونیاک (NH<sub>3</sub>)، اوزون (O<sub>3</sub>) وگازهای آلی از جمله: متان (CH4)، پروپان (SH<sub>8</sub>) و غیره هستند[۱۲].

نانو مواد به دلیل خواص برجستهای از جمله نسبت سطح به حجم بسیار بالا، در تشخیص گازها بسیار مورد توجه هستند [۱۳]. این ویژگیها بطور بالقوه میتواند منجر به ساخت حسگرهای نوینی با عملکرد استثنایی شود و همچنین کاهش اندازه تجهیزات و به حداقل رساندن مصرف انرژی را در پی داشته باشد [۱۳]. تقسیم حسگرها براساس نوع نیمه رساناها در شکل زیر بیان شده است:



شکل ۱-۶: تقسیم بندی حسگرها بر اساس نوع نیمهرساناها

مواد دو بعدی از جمله گرافن با توجه به ویژگیهای ریختشناسی سطحی به خصوص نسبت بالای سطح به حجم آن در زمینه حسگرها مورد توجه قرار گرفتهاند. با این حال نوار انرژی آن صفر یا نزدیک صفر است و این میتواند یک مانع برای استفاده از آن به عنوان حسگری باشد. از این رو، بسیاری از محققین گرافن آلایش یافته را معرفی کردند. سادهترین راه این است که از اکسید گرافن (GO) استفاده شود. ورقههای GO به راحتی می توانند از اکسید گرافیت تهیه شوند. اکسید گرافیت را میتوان از در معرض قرار دادن با اکسید کنندههای قوی بدست آورد. با این روش ساختار لایهای گرافیت حفظ میشود و با این حال فاصله بین سطوح گرافیت از یکدیگر افزایش مییابد. هنگامی که اکسید گرافیت در محلولهای پایه پراکنده میشود، مواد پودری در آب لایه لایه شده و منجر به تولید تکههای GO تک لایه میشود. مسیر اصلی ساخت اکسید گرافیتی و پس از آن ورقههای GO، روش هامرز <sup>(</sup> است، که به منظور به دست آوردن ورقههای GO با عیوب کمتر و افزایش تولید محصول آن را بهبود داده اند[۱۴].

مواد حساس هنگامی که در معرض گازهای مختلف مورد نظر قرار می گیرند، می توانند ویژگیهای الکتریکی و نوری خود را تغییر دهند. این حسگری به صورت تغییرات در سیگنال ایجاد می شود. لنر تس و همکاران [۶] سازوکار انتقال بار بین گرافن و گازهای مختلف را تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که H2O و NO2 به عنوان گیرنده و NH3، CO و NN به عنوان دهندهی الکترون در هنگام جذب سطحی در ورقه گرافن عمل می کنند.

جین و همکارانش [۱۳] حسگری GO کاهش یافته را برای تشخیص گاز آمونیاک مطالعه کردند و دریافتند که حسگر پس از تشخیص NH<sub>3</sub> به آهستگی بازیابی می شود. ا. ون کاتسان و همکارانش [۱۵] کامپوزیت RGO/MoS<sub>2</sub> را تهیه و رفتار حسگری نمونه رابرای گاز H<sub>3</sub>، H<sub>2</sub> و NN در دمای °C بررسی کردند. کامپوزیت RGO/MoS<sub>2</sub> پاسخ خوبی در حدود برای غلظت ۲۰۰ نسبت به گاز H<sub>2</sub> داشت. آنها بهبود حسگری در حساسیت و گزینندگی کامپوزیت در دمای عملیاتی را به علت شکل گیری ساختار یک پارچه نانو ذرات دی سولفید مولیبدن در بین منافذ لایههای RGO بیان کردند.

<sup>&#</sup>x27; Hummers

# ۱ – ۷ – جمع بندی

در این فصل به صورت مختصر به بررسی نحوی قرار گرفتن اتمهای کربن در گرافیت و گرافن پرداخته شد. سپس فرآیند کامل تهیه گرافن با استفاده از اکسایش گرافیت و تهیه اکسید گرافن و در نهایت روشهای کاهش اکسید گرافن بیان شد. همچنین ویژگیها و کاربردهای اکسید گرافن کاهش-یافته از جمله کامپوزیتها و حسگرها بیان شد. در فصل دوم بررسی گزارشهای منتشر شده در زمینهی تهیه اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته با دو روش حرارتی و شیمیایی پرداخته میشود. سپس معرفی مختصری بر حسگرها از جمله حسگر اکسید گرافن کاهش یافته و کامپوزیت ها ارائه میشود.

فمس دوم

مروری بر مقالات

#### ۲-۱- مقدمه

در این فصل به مرور مقالات سنتز اکسید گرافن، اکسید گرافن کاهش یافته و کامپوزیتهای آن با پلیمرها و سولفید فلزات و همچنین بررسی کاربرد حسگری گازی نمونهها پرداخته میشود. در بخش اول سنتز اکسید گرافن با استفاده از روش هامرز و روند بهبود آن مرور میشود. در بخش دوم به بررسی تاثیر حرارت بر کاهش اکسید گرافن میپردازیم و در بخش سوم به بررسی انواع کاهش دهندههای شیمیایی در فرآیند کاهش پرداخته میشود. در بخش چهارم برخی کامپوزیتهای گرافن با پلیمرها و اکسیدهای فلزی مرور میشوند و در بخش نهایی به بررسی کاربرد حسگری اکسید گرافن و کامپوزیت-

## ۲-۲- سنتز اکسید گرافن به روش هامرز

رایج ترین روش جهت تهیه اکسید گرافن (GO) روش هامرز بهبود یافته است. در روش هامرز (Hummers) از سدیم نیترات (NaNO، پتاسیم پرمنگنات KMnO4، اسید سولفوریک H2SO4 جهت انجام واکنش اکسیداسیون استفاد میشود. در طی تحقیقات پژوهشگران متوجه شدهاند که با حذف مaco (Humors) افزایش مقدار KMnO4 و انجام واکنش با ترکیب نسبت حجمی ۹: ۱ از APO4 / H3PO4 / H2SO4 فرآیند اکسیداسیون بهبود مییابد و مقدار زیادتری اکسید گرافن آب دوست در مقایسه با روش فرآیند اکسیداسیون بهبود مییابد و مقدار زیادتری اکسید گرافن آب دوست در مقایسه با روش فرآیند اکسیداسیون بهبود مییابد و مقدار زیادتری اکسید گرافن آب دوست در مقایسه با روش است. از کاهش اکسید گرافن تهیه شده از هر دو روش با هیدرازین مشخص شد که هدایت الکتریکی هر دو ماده یکسان است. اصلی ترین مانع جهت دستیابی به گرافن تک یا چند لایه غلبه بر نیروهای واندروالسی بین لایهای است. به همین دلیل در جهت لایه برداری تلاشهای فراوانی صورت گرفته است. اختلال ساختاری در گرافیت و اکسید گرافن با افزایش فاصله بین دو لایه از مسیمایی از جمله اکسیداسیون، بیان شده است [۸]. مرسومترین منبع گرافیت مورد استفاده واکنشهای شیمیایی از جمله اکسیداسیون، GO آماده شده از گرافیت ورقه شده میتواند به راحتی در آب پراکنده شود و در مقیاس بزرگ برای تهیه لایههای بزرگ گرافیتی، به عنوان یک اتصال دهنده برای محصولات کربن و یا به عنوان بخشی از کاتد باتریهای لیتیوم مورد استفاده قرار گیرد. برخلاف روش هامرز درروش هامرز بهبود یافته جدید گاز سمی تولید نمیشود و کنترل دما به راحتی امکان پذیر است [۱۶].

# ۲-۳- سنتز و مشخصه یابی اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته

ام اسلام و همکاران اکسید گرافن را با استفاده از روش هامرز بهبود یافته (بدون استفاده از سدیم نیترات( NaNO3) تهیه کردند [۱۷]. سپس برای از بین بردن گروههای اکسیژندار ایجاد شده در بین ورقهها با استفاده از هیدرازین منوهیدرات کاهش شیمیایی اکسید گرافن انجام شد. روش تهیه نانو ورقههای اکسید گرافن به این شرح گزارش شده است که ابتدا ترکیبی از اسید فسفوریک و اسید سولفوریک (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> : H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) با نسبت حجمی مشخص (۱۰۹) آماد شد. g ۳ پودر گرافیت در دمای اتاق به محلول اسیدی اضافه شد و به مدت ۱ ساعت برروی همزن قرار گرفت. g ۸۸ پتاسیم پرمنگنات (KMnO4) به آرامی (به علت حرارت زا بودن واکنش) به آن اضافه شد در این مرحله تا حدود C<sup>o</sup> ۲۰ افزایش و به مدت ۱۲ ساعت انجام واکنش ادامه یافت. سپس Lm ۳ از 2O<sub>2</sub> ۳۰ درصد به همراه Lm فرایش و به مدت ۱۲ ساعت انجام واکنش ادامه یافت. سپس Jm ۳ از 2O<sub>1</sub> ۳۰ درصد به همراه Lm فرایش و به مدت ۱۲ ساعت انجام واکنش ادامه یافت. سپس Jm ۳ از 2O<sub>1</sub> ۳۰ در در نهایت ترکیب افزایش و به مدت ۱۲ ساعت انجام واکنش ادامه یافت. سپس Jm ۳ از 12O ۲۰۰ در کوره خلا فرآیند خشکسازی حاصل با ICH و آب مقطر با سانتریفیوژ شستشو شد و در دمای C<sup>0</sup> ۹۰ در کوره خلا فرآیند خشکسازی حواصل با ICH و آب مقطر با سانتریفیوژ شستشو شد و در دمای ROP به OOP به OPR به صورت زیر انجام شد [۱۷].

کاهش GO با استفاده از هیدرازین هیدرات که یک کاهش دهنده یقوی و سمی است انجام گرفت. ابتدا GO نانو ورقههای GO در GO در ۱۰۰ آب پراکنده شد و به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق بر روی التراسونیک جهت ایجاد پراکندگی بهتر قرار گرفت. سپس با اضافه کردن ۱ mL هیدرازین هیدرات و قرار دادن در دمای C<sup>o</sup> ۱۰۰ به مدت ۲۴ ساعت تحت سیستم رفلاکس فرآیند کاهش انجام شد. پس از اتمام واکنش، کاهش محصول بدست آمده را با آب مقطر شستشو داده و در دمای C<sup>o</sup> ۶۰ خشک شد[۱۷].

شکل ۲-۱ مربوط به طیف جذب دستگاه طیف سنجی (UV-Vis) نمونههای GO و RGO است. طیف جذب GO یک قله در r۲۴ nm را نشان میدهد که به علت گروههای اکسیژن دار، پس از کاهش با هیدرازین قله به ra۸ nm ۲۵۸ انتقال یافت که این نشان دهندهی موفقیت آمیز کاهش اکسیدگرافن و تهیه RGO است. در طیف RGO یک انتقال مشاهده می شود که احتمالا به علت بازسازی حلقههای آروماتیک و ترمیم پیوندهای بین صفحات و حذف گروههای اکسیژندار در طی فرآیند کاهش اکسید گرافن است [۱۷].



شكل ۲-۱ : طيف جذب اكسيد گرافن و اكسيد گرافن كاهش يافته[۱۷]

شکل ۲-۲ آنالیز FTIR طیف نگار نمونهها را نشان میدهد که گروههای اکسیژندار نانو ورقهها GO و کاهش یا عدم حضور آنها در نانو ورقههای RGO بررسی شد. بر روی صفحات نازک GO مولکولهای اپوکسی و هیدروکسیل و در لبههای ورقهها گروههای کربوکسیل و کربونیل قرار دارند. در مقالات دیگر
از وجود گروههای مولکولی دیگری مانند کیتون<sup>۱</sup> و فنول<sup>۲</sup> بر روی صفحات و گروههای لاکتون<sup>۳</sup>، فنول، پیرون<sup>۴</sup> و کیتون در لبه صفحات گزارش شده است. قله جذب در محدودی <sup>۱</sup>-۳۲۹۷ مربوط به ارتعاشات کشش گروههای هیدروکسیل (OH-) در نانو صفحات GO که باعث ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین مولکولهای آب و لایههای گرافیت میشود است. که نشان دهندهی ماهیت آب دوستی نمونه GO است. در نمونه RGO کاهش شدید این قله بیان کننده غیر آب دوستی ماده است[۱۷].



شکل ۲ – ۲ :طیف نگاری مادون قرمز اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته[۱۷].

شکل ۲-۳ الگوی پراش XRD نمونههای GO و RGO را نشان میدهد. قله بلورین شش گوشی از گرافیت در حدود<sup>°</sup> ۲۶/۶ با فاصله بین صفحات nm ۲۴/۰ واقع است که بعد از اکسایش این قله ناپدید شده و یک قله دیگری در زاویه <sup>°</sup>۱۰ با فاصله بین ورقههای حدود nm ۱۵/۰ در راستای صفحات (۰۰۱) دیده شد که نشان دهندهی اکسایش موفقیت آمیز اکسیدگرافن و افزایش فاصله بین لایهها (b) بوده

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keaton

شPhenol ۲

<sup>&</sup>quot; Lactone

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Peyron

است. این افزایش به علت ایجاد گروههای اکسیژن دار مانند اپوکسی، کربونیل، هیدروکسیل، کربوکسیل و غیره در بین نانو صفحات و در واقع ایجاد نقص ساختاری است. بعد از فرآیند کاهش قله RGO در حد فاصله زاویه ۲۱/۹<sup>°</sup> ۲۱/۴<sup>°</sup> در راستای صفحه (۲۰۲) با فاصله بین لایه ها در حدود nm ۲۶/۴۰ دیده شد. که اندازه بلورکها از رابطه شرر در حدود nm ۸ / ۱۲ بدست آمد. بعد از کاهش بازسازی ساختاری پیوندهای کربنها در صفحات گرافنی باعث ایجاد این قله شد، که پهن بودن آن مربوط به وجود نقایص است. تفاوت فاصله d بین لایههای گرافیتی و ورقههای RGO در حدود nm در حدود RGO



شكل ٢ - ٣ : الكويي پراش پرتو ايكس اكسيد كرافن واكسيد كرافن كاهش يافته [١٧].

# ۲-۴- کاهش حرارتی از اکسید گرافن ورقهای

هاریما سلیم و همکاران [۱۸] روش سنتز شیمیایی اکسید گرافن با استفاده روش هامرز بهبود یافته و لایه برداری و در نهایت کاهش حرارتی آن را بررسی کردند. در این گزارش g ۳ پودر گرافیت و ۱۸ g پتاسیم پرمنگنات را در محلول اسیدی متشکل از اسید فسفوریک و اسید سولفوریک به نسبت حجمی (۱:۹) اضافه شد. ترکیب حاصل برای مدت ۴ تا ۵ ساعت بروی هم زن با کنترل دمای  $^{\circ}$  20 ۴۰ قرار گرفت. سپس به مدت ۱۲ ساعت این واکنش تا سرد شدن ادامه یافت. با اضافه کردن ۳۱ آب مقطر یخ زده به همراه 1 ۵ آب اکسیژنه (H2O2) رنگ مسی محلول قبلی به رنگ زرد تبدیل شد و با HCl امولار تا زمانیکه به pH مد نظر برسد شستشو داده شد. جهت لایه برداری اکسید گرافن برای مدت ۳۰ دقیقه در شرایط عادی در آب پراکنده شد و به مدت ۲۴ ساعت تحت خلا خشک گردید. کاهش حرارتی GO در دمای ۲۰°۵۰ برای مدت ۲ ساعت انجام شد [۱۸].

آنالیز پراش پرتو x جهت تعیین ساختار بلوری و پارامترهای شبکه GO وRGO استفاده شد (شکل ۲-۲). در طی فرآیند اکسایش قله شدید در گرافیت با راستای صفحه (۲۰۲) با زاویه<sup>°</sup> ۲۶/۴۷ و فاصله صفحات <sup>°</sup>A ۲/۴ به تدریج ناپدید شد و در راستای صفحهی (۰۰۱) با زاویه<sup>°</sup> ۱۱/۸ و فاصله صفحات ۵/۵۸<sup>°</sup> در اکسید گرافن تغییر یافت. پس از کاهش حرارتی اکسید گرافن و تهیه RGO ساختار بلوری با پیدایش دوباره قله در راستای (۰۰۲) در زاویه <sup>°</sup>۲۵/۵ درجه و ناپدید شدن قله (۰۰۱) در <sup>°</sup>۱۱/۸ ترمیم گردید [۱۸].



شكل ۲ – ۴ : الگوى پراش پرتو ايكس نمونهها اكسيد گرافن و گرافيت [۱۸]..

در شکل ۲-۵ تصاویر میکروسکوپی الکترونی نشان میدهد که صفحات گرافیت به صورت لایههای فشرده بر روی یکدیگر قرار گرفتهاند که بعد از اکسایش فاصلهی این ورقهها از یکدیگر بیشتر شد [۱۸].



شكل ۲ – ۵ : تصاوير ميكروسكوپي الكتروني نمونه ها [۱۸].

شکل ۲-۶ طیف جذب نمونهها را نشان میدهد. ابتدا محلول حاوی ۱۰mg از نمونه GO و RGO به طور جداگانه در ۱۰ ml آب مقطر حل شد و سپس طیف آنها ثبت شد.

علت این انتقال طول موج بعد از کاهش در GO را میتوان حذف اکسیژنهای موجود ورقههای گرافن بعد از عملیات حرارتی بیان کرد. همچنین مشخص شد که نانو ورقههای GO آب دوست و نانو ورقههای RGO غیر آب دوست هستند و در آب برای مدت زمان کوتاهی پایدارند [۱۸].



شکل ۲-۶: طیف جذب نمونههای GO با RGO [۱۸].

۲–۵– کاهش شیمیایی اکسید گرافن برای حسگری گاز آمونیاک در دمای اتاق

رامان قوش و همکاران در پژوهش خود تهیه اکسید گرافن با روش هامرز و کاهش آن توسط سدیم بروهیدرید را گزارش کردند [۱۹]. سپس نمونه را برای آشکارسازی گاز آمونیاک در دمای اتاق مورد آزمایش قراردادند. قطعه حسگر بروی زیرلایه سرامیکی تهیه و با استفاده از پلاتین اکترودگذاری شد. اثر مدت زمان کاهش شمیایی برعملگرد حسگری بررسی شد. آزمایش حسگری در دمای اتاق و برای آمونیاک انجام شد. جهت آزمایش نمونه حسگری به مدت ۱۵دقیقه در معرض گاز هدف آمونیاک قرار گرفت. در هر مرحله جهت بازیابی نمونه به مدت ۲۰ دقیقه در معرض گاز بیاثر داده شد. در اینجا برای شش غلظت مختلف از گاز آمونیاک از ۲۰۰ تا ۲۸۰۰ pm

در شکل ۲-۷ نتایج حسگری گازی نمونه گزارش شده است که با افزایش غلظت گاز پاسخ حسگری افزایش یافته است. نمونهی حسگر برای غلظت ۲۰۰ ppm پاسخ ۵۵ ٪ و ۲۸۰۰ ppm پاسخ ۲۳ ٪ برای گاز آمونیاک گزارش شد [۱۹].



شکل ۲- ۷ : حسگری گازی نمونه اکسید گرافن کاهش یافته برای

غلظتهای مختلف گاز هدف آمونیاک[۱۹]

در شکل ۲-۸ پاسخ قطعه حسگری در غلظتهای مختلف گاز نشان داده شده است. این تغییرات با افزایش غلظت به صورت خطی افزایش یافته است. در این نمونه کاهش حرارتی در ۹۰ دقیقه انجام شد[۱۹].



شكل ۲ – ۸: تغييرات حساسيت متناسب افزايش [۱۹]

در شکل ۲-۹ مقایسه پاسخهای ترکیبات آلی مختلف برای نمونهی حسگری نشان داده شده است. اندازهی گزینندگی فیلم RGO با تغییر مقدار مقاومت لایه حسگر در حضور چندین ترکیب آلی فرار (VOCS) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه در معرض ۷۰ از تتراهیدرافوران (THF) استون، کلروفرم، کلروبزون، تولوین و متانول در دمای اتاق قرار داده شد. حسگر گزینندگی خوبی نسبت به گاز آمونیاک نشان داد [۱۹].



شکل ۲ – ۹: مقایسه پاسخ های ترکیبات آلی مختلف برای نمونهی حسگری[۱۹]

### ۲-۶- روش دو مرحله ای هیدروترمال جهت تهیه نانو کامپوزیت

شان لی و همگکارانش ۴۰mg اکسید گرافن را در ml ۴۰ آب مقطر به مدت ۱ ساعت در التراسونیک جهت تهیه سوسپانسیون، حل شد. g ۰/۱۸۱۶ آمونیوم هپتا مولیبدات تترا هیدرات و ۰/۱۸۲g التراسونیک جهت تهیه سوسپانسیون، حل شد. g ۵/۱۱ آمونیوم هپتا مولیبدات تترا هیدرات و ۰/۱۸۲g تیوره در ml ۲۰ آب مقطر اضافه شد و به آرامی در محلول GO اضافه گردید. محلول ۳۰ دقیقه برروی التراسونیک و سپس در یک راکتور فشار بالا در دمای ۲۰۰° ۲۰۰۲ به مدت ۲۴ ساعت حرارت داده شد. g MoS<sub>2</sub> از شستشویی محلول، به مدت ۱۴ ساعت در دمای ۶۰° خشک شد. در این مرحله کامپوزیت RGO

جهت تهیه کامپوزیت ( MOS2 / RGO @ PANI )، ابتدا MI از NGO / RGO در MOS2 / RGO در RGO د. دیونیز حل شد. محلول برای مدت ۳۰ دقیقه در التراسونیک جهت تهیه سوسپانسیون قرار گرفت. ۱/۴۲ ml آنیلین و ۳۱ ۸/۸۶ اسید هیدروکسید در ۲۱ ۲۱ آب دیونیز شده برای مدت ۳۰ دقیقه اضافه شد [۲۰]. محلول حاصل به آرامی به صورت قطرهای به سوسپانسیون RGO / MOS2 اضافه شد به مدت ۱ ساعت جهت پراکنده شدن آنیلین در بین نانو ذرات MOS / RGO بر روی التراسونیک قرار گرفت. ۱ ساعت جهت پراکنده شدن آنیلین در بین نانو ذرات MOS / RGO بر روی التراسونیک قرار گرفت. از اتمام واکنش محصول ۸ ۹۸۱ هم MOS / RGO به مدت ۴۲ ساعت خشک گردید. (شکل ۲-از اتمام واکنش محصول ۲۹۸۱ آ.



شكل ۲ – ۱۰ : طرحوارهای از سنتز كامپوزیت MoS<sub>2</sub> / RGO @ PANI [۲۰].

در شکل ۲–۱۱ قلههای رامان در RGO / RGO در ۳۷۵ و<sup> $(-1)</sup> ۴۰۸ cm مشخص شد که مربوط BC2 / RGO به حالت <math>E_{2g}$  و  $E_{1g}$  و  $E_{2g}$  است. دو قله دیگر در ۱۳۲۶ و  $(-100 \text{ cm}^{-1})$  مربوط به گروه D و گروه RGO است. از RGO است.</sup>



شكل ٢ – ١١ : طيف رامان MoS<sub>2</sub> / RGO ، PANI و MoS<sub>2</sub> / RGO (PANI [ ٢٠].

در شکل ۲–۱۲ الگوی پراش XRD برای نمونههای MoS<sub>2</sub> / RGO ،PANI و MoS<sub>2</sub> / @ PANI ، ۱۴/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۶/۷ نشان داده شده است. قلههای پراش برای نمونه MoS<sub>2</sub> / RGO در زاویههای ۱۴/۱ ، ۱۴/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۳/۱ ، ۳۶/۷ ، ۳۶/۷ ، ۳۶/۷ و ۳۵/۹<sup>۰</sup> و ۵۸/۹<sup>۰</sup> به ترتیب مربوط به صفحات (۰۰۲)، (۱۰۰)، (۱۰۲)، (۱۰۲)، (۱۰۶)

(۱۱۰) می باشد.



شکل ۲ – ۱۲ : الگوی پراش پرتو ایکس پلی آنیلین و نانو کامپوزیت

قله موجود در راستای صفحهی (۰۰۲) مربوط به زاویه ۲۶/۵<sup>°</sup> در RGO است. قلههای پراکندگی از PANI در زاویه ۱۴/۴ ، ۲۰/۳ و ۲۵/۳<sup>°</sup> مربوط به راستای صفحات (۰۱۱)، (۰۲۰)و (۲۰۰) میباشد قلههای MoS<sub>2</sub> / RGO ،PANI و MoS<sub>2</sub> / RGO @ PANI به وضوح در الگوی کامپوزیت MoS<sub>2</sub> / RGO @ PANI @ MoS<sub>2</sub> / RGO شکل گرفته اند [۲۰]

### MoS₂ – RGO سنتز لایه های فعال دو بعدی از هیبرید MoS₂ – RGO

سواگاتیکا کاملی و همکارن سنتز کروههای تو خالی دی سولفید ( MoS<sub>2</sub>) و اکسید گرافن کاهش یافته و کامپوزیت (MoS<sub>2</sub> – RGO) را گزارش کردند و ویژگیهای آنها را مورد بررسی قرار دادند [۲۱]. اکسید گرافن را با استفاده از روش هامرز بهبود یافته سنتز کردند و برای کاهش آن mg ۱۰ اکسید گرافن را در ۳۰ml آب دیونیز شده حل کردند و به مدت ۳۰ دقیقه داخل التراسونیک قرار دادند. سپس محلول را در داخل راکتور با دمای ۲۰۰<sup>o</sup> به مدت ۲۵ ساعت جهت انجام فرآیند کاهش قرار دادند. برای سنتز MoS<sub>2</sub> از فرآیند هیدرترمال یک مرحلهی استفاده گردید. به این صورت که g ۶/۰ آمونیوم هپتا مولیبدن و g ۷۵ /۰ تیوره و g ۱/۰ (PEG) در m۱ ۳۰ آب دیونیز اضافه شد و برای مدت



شكل ٢ – ١٣ : الگويي از سنتز نانو كامپوزيت MoS<sub>2</sub> – RGO [٢١].

سپس محلول حاصل را در اتوکلاو برای مدت ۲۴ ساعت تحت ۲۰۰<sup>o</sup>C درجه قرار دادند. محصول را با آب و اتانول شسشو و برای ۱۲ ساعت تحت دمای۲<sup>o</sup>C خشک نمودند. سنتز کامپوزیت – MoS<sub>2</sub> – را نیز مشابه سنتز MoS<sub>2</sub> را نیز مشابه سنتز MoS<sub>2</sub> انجام دادند [۲۱].

در شکل ۲–۱۴ الگوی رامان نمونهها آورده شده است. قلههای نمایان شده در ۳۷۷، ۴۰۳، ۴۴۹و <sup>-</sup>cm مربوط ۲۰ مربوط به مدهای مختلف ساختار MoS2 است. همچنین حضور قلههای ۸۱۴ و ۱۹۳۲ مربوط به حالت کششی اکسیژن در MoO3 است که ممکن است به علت اکسیدشدن MoS2 بعد از قرار گرفتن در معرض هوا باشد.



شكل ٢ - ١۴ : الكوى طيف رامان كامپوزيت MoS<sub>2</sub> - RGO [٢١].

# سنتز نانو کامپوزیتهای $MoS_2 - RGO$ برای حسگری هیدروژن – ۸–۲

ون کاتسان و همکاران [۱۵] حسگری گاز هیدروژن را با استفاده از لایه ناز ک کامپوزیت MoS2 ون کامپوزیت RGO – مورد بررسی قرار دادند. سنتز اکسید گرافن با استفاده از روش هامرز بهبود یافته انجام شد. برای تهیه نانو ذرات MOS2 ، g ۸۰/آمونیوم هپتا مولیبدات تترا هیدرات در m۱ ۱۰۰ آب برای مدت ۳۰ دقیقه پراکنده و در طول فرآیند حل شدن m۱ ۲ اسید هیدروکلریک Hcl اضافه میشود. تغییر رنگ محلول از قرمز به سیاه نشان دهنده ی تشکیل نانو ذرات MOS2 است در نهایت محلول در دمای ۲°۰ برای مدت ۲۱ ساعت خشک سازی میشود. در شکل ۲–۱۵ الگویی از شکل گیری فرآیند – MoS2 برای مدت ۱۲ ساعت خشک سازی میشود. در شکل ۲–۱۵ الگویی از شکل گیری فرآیند – MoS2 برای مدت ۱۲ ساعت برای تهیه لایه حساس ۳ ۱ نانو ذرات MOS2 به m1 ۱۰ از این محلول آبی GO اضافه و به مدت ۱ ساعت بروی التراسونیک پراکنده میشود. در نهایت m1 از این محلول بروی الکترود قرار گرفته و در دمای C<sup>o</sup>۰۹ باز پخت شد[۱۵].

کامپوزیت MoS<sub>2</sub> – RGO پاسخ بسیار خوبی در حدود ۱۵ ٪ برای MoS<sub>2</sub> – RGO کاز هدف H<sub>2</sub> دمای <sup>9</sup> ۲۰۰ از خود نشان داد. علاوه بر این کامپوزیت MoS<sub>2</sub> – RGO انتخاب پذیری عالی نسبت به H<sub>2</sub> در مقایسه با NH<sub>3</sub> و NN نشان داد. مطابق نتایج حاصل از این پژوهش پاسخ MOS<sub>2</sub> – RGO برای کاز H<sub>2</sub> نسبت به NH<sub>3</sub> و NH حدود ۲/۹ و نسبت به NO حدود ۳/۵ برابر است. علت گزینندگی و حساسیت بهبود یافته حسگری MoS<sub>2</sub> – RGO مربوط به ساختار یکپارچه نانو ذرات در MoS<sub>2</sub> در بین نانوکانالها و نانو منافذ لایههای RGO است[10].



شكل ۲ – ۱۵: الكويي از سنتز اكسيد كرافن با استفاده از روش هامرز بهبود يافته و تهيه نانو كامپوزيت [۱۵].

ویژگی حسگری گازی RGO – MOS – MoS با قرار گرفتن در معرض غلظتهای مختلف گازهای هدف در دمای اتاق تا C<sup>o</sup> ۶۰ با بررسی تغییرات مقاومت مورد مطالعه قرار گرفت. گاز هدف به مدت ۴۰۰۶ در محفظه تزریق شد و به مدت ۳۰۰۶ ثانیه خارج شد. کل دورهای حسگری ۷۰۰۶ برای هر غلظت در نظر گرفته شد. در شکل ۲–۱۶ حسگری نمونه ها برای دو غلظت در دماهای مختلف نشان داده شده است. حسگر RGO – MOS در مقایسه با نمونهها دیگر پاسخ و بازیابی بهتری از خود نشان داد [1۵].



در شکل ۲–۱۷ پاسخ کامپوزیت مبتنی بر نانوذرات RGO / MoS<sub>2</sub> در دمای ۶۰<sup>°</sup>C برای ۲۰۰ ppm



و ۵۰۰ ppm برای گازهای NO ،H<sub>2</sub> و NH<sub>3</sub> نشان داده شده است [۱۵].

شکل ۲ –۱۷ : پاسخ حساسیت کامپوزیت مبتنی بر نانوذرات RGO / MoS<sub>2</sub> در دمای ۶۰C برای ۲۰۰ppm و ۲۰۰ppm برای گاز های H<sub>2</sub> NO (1

## ۲ - ۹- جمع بندی

در این فصل به بررسی و مطالعه روشهای سنتز اکسید گرافن با استفاده از روش هامرز بهبود یافته و کاهش آن با استفاده از روشهای شیمیایی و حرارتی پرداخته شد و در ادامه به بررسی تهیه کامپوزیت-ها برمبنای اکسید گرافن کاهش یافته مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت به مطالعه کاربردهای کامپوزیتها در زمینه حسگری اشاره شد.

فصل سوم

روش مى ستر ومشخصهابى

#### ۳–۱– مقدمه

در سالهای اخیر نانوساختار به دلیل کاربردهای فراوان در زمینههای مختلف نظیر الکترونیک، اپتیک، کاتالیزوری و غیره توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. اندازه، ساختار و برهمکنشهای بین اتمی و مولکولی تعیینکننده خواص منحصربه فرد این مواد است. بنابراین، درک بهتر و بررسی ساختارها و مشخصهیابی آنها اجتناب ناپذیر است. مشخصهیابی مواد نانومتری عبارت است از تعیین مشخصات متنوع نانو ساختارها اعم از اندازه ذرات، شکل ذرات، توزیع، و بررسی خواص نوری، مکانیکی، مغناطیسی، سطحی و شیمیایی و غیره میباشد. برای تعیین هر یک از خصوصیات ذکر شده از ابزار و روشها استفاده میشود که اطلاعات دقیق و مفیدی از ساختار، اندازه و خواص مواد به دست آید. در این بخش به معرفی بعضی از روشهای رشد و مشخصهیابی نانو ساختارهای بکار رفته در این پایان نامه مانند روش آب-گرمایی، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی<sup>۱</sup> (RESEM)، پراش پرتو ایکس<sup>۲</sup> (XRD)، طیف نگار نوری<sup>۳</sup> (وار-UV)، طیف نگار رامان<sup>†</sup> (Raman)، طیف نگار تبدیل فوریه مادون قرمز<sup>۵</sup> (RTIP) و حسگر گازی پراخته میشود.

# ۲-۲- روش آب-گرمایی

در بین روشهای از پایین به بالا روش آب-گرمایی<sup>۶</sup> به علت سادگی و مقرون به صرفه بودن به عنوان یکی از پرکاربردترین روشها برای تهیه نانو ساختارها مورد توجه قرارگرفته است. به طور کلی، در این روش ابتدا واکنش دهندهها در حلال مناسب حل میشوند. در صورت نیاز برای حل شدن یا توزیع بهتر پیش مادهها در محلول، از امواج اولتراسونیک استفاده میشود. سپس محلول مواد اولیه درون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scanning Electron Microscope

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> X-Ray Diffraction

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Ultraviolet–visible spectroscopy

<sup>&</sup>lt;sup>f</sup> Raman Spectroscopy

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Fourier-transform infrared spectroscopy

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> Hydrothermal

اتوکلاو ریخته و تا دمای مناسب حرارتدهی میشود. در اثر این حرارتدهی فشار درون اتوکلاو بالا رفته و شرایط مناسب برای واکنش پیش مادهها فراهم میشود. پس از گذشت زمان کافی برای انجام واکنش شیمیایی درون اتوکلاو، حرارتدهی متوقف و محصول نهایی در صورت نیاز برای خشکسازی تحت حرارت قرار میگیرد. مزایای روش آب-گرمایی بازدهی بالا، کنترلپذیری مطلوب، آسان بودن روش، تولید محصول با توزیع اندازه یکنواخت، مصرف انرژی کمتر، آسیب رسانی کمتر به محیط زیست است. فناوری هیدروترمال روش قدرتمندی در تولید نانومواد به حساب میآید. در این تحقیق از این روش آب-گرمایی به منظور سنتز نانو کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با سولفید مولیبدن استفاده شد[۲۱].

## FESEM) ميكروسكوپ الكتروني روبشي اثر ميداني (FESEM)

امروزه روشهای مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها روشهای میکروسکوپی است. از معروفترین و پرکاربردترین میکروسکوپهای الکترونی میتوان به میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدان اشار کرد. این میکروسکوپ برمبنای برهم کنش پرتوی الکترونی با ماده است. در این روش نمونه با پرتوهای الکترونی روبش شده و این باعث جدا شدن الکترونها و فوتونهایی به سمت آشکار ساز می شود و در این قسمت به سیگنال تبدیل میشود وتوسط آشکار ساز دریافت و در نهایت به تصویر و یا دیگر اطلاعات مورد نیاز تبدیل می شود [۲۲].

جهت تجزیه و تحلیل ساختاری و خصوصیات شیمیایی نمونهها از طیف نگار پرتو ایکس<sup>۱</sup>(EDAX) استفاده میشود. این روش بطور کلی بر این اساس میباشد که هر عنصر دارای ساختار اتمی منحصر به فرد خود است که مجموعه قلههای منحصر به فرد را در طیف پرتو ایکس آن می سازد. برای برانگیختن پرتو ایکس مشخصه از نمونه، یک دسته پرتو پر انرژی الکترون به نمونه متمرکز میشود. پرتو اعمال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energy Dispersive Spectroscopy

شده احتمال دارد یک الکترون در تراز درونی را تحریک کند و آن را از تراز خارج کند، و باعث ایجاد جای خالی شود. سپس یک الکترون با انرژی بالاتر از ترازهای بیرونی، جای خالی را پر می کند. تعداد و انرژی پرتو ایکس گسیل شده از نمونه را به کمک یک طیف نگار پراش انرژی اندازه گیری می کنند. از آن جا که انرژی پرتو ایکس بیان کننده اختلاف انرژی بین دو لایه و همچنین ساختار اتمی عنصری است که از آن گسیل شده است، امکان اندازه گیری ترکیب عناصر نمونه ایجاد می شود [۲۳]. شکل ۳-۱ نمایی از میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل میدان مورد استفاده در این پایان نامه را نشان می دهد.



شکل ۳-۱ : میکروسکوپ الکترون روبشی گسیل اثر میدان مدل FESEM; Hitschi S-416 مورد استفاده شده در این پایان نامه

## X – ۴– پراش پر تو

در صورتی الکترونهای وابسته به اتمهای یک بلور توسط پرتو ایکس به نوسانات متناوب تحریک شوند، تعداد زیادی منابع نوری با فرکانس یکسان با پرتو فرودی شده، ایجاد میکند. موج های پراکنده شده با یکدیگر تداخل نموده و در صورتی که فاز بین دو پرتو متوالی مضرب درستی از ۲π یا اختلاف راه آنها مضرب درستی از طول موج باشد (رابطه ۲–۱)، بیشینهی شدت حاصل می شود. بدین ترتیب نقاط تاریک و روشن حاصل می شود. نقاط روشن دارای شدتهای مختلف می باشد که مقدار آن به عامل پراکندگی اتمها یعنی به تعداد و توزیع الکترونی در اتمها و به عامل ساختار که مربوط به پیکربندی یاخته اولیه است بستگی دارد [۲۴]. شکل ۳–۲ نقش پراش پرتو X از سطح یک بلور را نشان می دهد. نمونهها در محل مورد نظر قرار گرفته و پرتویی با طول موج °۱/۵۴۸ به سطح نمونه فرود می آید. از آنجا که نگهدارنده نمونه قابل چرخش است تابش فرودی می تواند با زوایای مختلف سطح را جاروب کند. به کمک الگوی پراش بدست آمده می توان پارامترهای مهمی از نانوساختارها نظیر نوع ساختار بلوری با توجه به موقعیت قله ها و مقایسه آن با کارتهای استاندارد ( 'JCPDS) و راستای رشد ترجیحی را یافت.

شکل ۳-۳ نمونهای از دستگاه پراش پرتو ایکس به کار گرفته شده در این پایان نامه را نشان میدهد. همچنین به کمک این دادهها میتوان اندازه بلورکها، چگالی دررفتگیها، کرنشها، فاصله بین صفحات بلوری و ثابتهای شبکهای ماده مورد نظر را به شرح زیر محاسبه کرد.

به منظور تعیین ثابتهای شبکهای یک بلور (بسبلور) لازم است از فاصله بین صفحات بلوری (b) اطلاع داشته باشیم. برای این مقصود می توان از قانون براگ به صورت [۲۵] :

$$2d_{hkl}\sin(\theta_{hkl}) = n\lambda \tag{1-7}$$

استفاده کرد. در این رابطه  $d_{hkl}$  فاصله بین صفحات مجاور در راستای  $\theta_{hkl}$  ،hkl زاویه پراش، n مرتبه  $\eta_{kl}$  راستای  $\theta_{hkl}$  ،hkl زار و  $\lambda$  طول موج پرتو x است. اکنون با معلوم شدن d و با استفاده از رابطه زیر که برای ساختارهای شش گوشی [۲۶]:

$$\frac{1}{d_{(hkl)}^2} = \left[\frac{h^2 + hk + k^2}{a^2}\right] + \frac{4}{3}\frac{l^2}{c^2}$$
(Y-Y)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Joint Committe of Pwder Diffraction Society

و همچنین ساختار مکعبی  

$$d^2 = \frac{a^2}{h^2 + k^2 + l^2}$$
 $(7-7)$ 
 $(-7)$ 
 $d^2 = \frac{a^2}{h^2 + k^2 + l^2}$ 
 $d^2 = \frac{a^2}{h^2 + k^2 + l^2}$ 
 $d^2 = 0$ 
 $d^2 = 0$ 

(nm)، 
$$heta$$
 زاویه براک موقعیت زاویهای قله پراش (برحسب درجه)، A عدد ثابت (معمولا ۱) و  $eta$  پهنای قله در نیمه بیشینه آن ('FWHM) و بر حسب رادیان قله پراش است. با استفاده از شیب خطی فراد و sin  $heta$  میزان کرنش (٤) لایه و چگالی دررفتگی لایهها (δ)به ترتیب با رابطههای زیر محاسبه میشوند [۲۷]. D در این روابط اندازه بلورک است.

$$\varepsilon = \frac{\beta}{4 \tan \theta}$$
 (Δ-Υ)  
$$\delta = \frac{1}{D^2}$$
 (۶-Υ)



شکل ۳ – ۲ :پراش پرتوX از سطح یک بلور

<sup>&</sup>lt;sup>\</sup> Full Width of Half Maximum



شکل ۳ – ۳ : دستگاه آنالیز پراش پرتو ایکس دانشگاه دامغان مدل-Bruker D8 (Cu Kα1(λ=0.15406))Avance (راین پایان نامه)

در این پایان نامه از دستگاه *مد*لBruker D8-Avance((Cu Kα1(λ=0.15406)) استفاده شده است. شکل۳-۳ تصویر دستگاه را نشان میدهد.

# UV-Vis طیف نگار نوری UV-Vis

طیف نگار مرئی- فرابنفش یکی از روشهای مورد استفاده در علوم تجربی برای دریافت اطلاعات علمی و عملی، با استفاده از برهمکنش نور و ماده میباشد. در طیف سنجی باریکهای از نور به ماده ی مورد نظر تابانده شده و با بررسی نور بازتابشی یا جذبی یا نشری به دریافت اطلاعات پرداخته میشود. یکی از کاربردهای استفاده از طیف نگار برای بررسی خواص اپتیکی واندازه نانو ذرات است. خروجی طیف سنج نموداری از شدت نور جذبی بر حسب طول موج است، در مورد نانو ذراتی که دارای یک قله جذبی در ناحیه مرئی میباشند، اگر قله جذب اپتیکی به سمت طول موجهای بلندتر و فرکانسهای کمتر باشد، یعنی ذرات اندازه ی بزرگتری دارند که در اصطلاح "انتقال به قرمز" میباشد و اگر به سمت طول موجهای کوتاهتر باشد که برای لبه ی جذب انتقالی به سمت انرژیهای بالاتر وجود دارد، این وضعیت "انتقال به آبی" نام دارد، یعنی ذرات اندازهی کوچکتری دارند. طبق تعریف عبور (T)<sup>۱</sup> کسری از تابش فرودی است که توسط محلول عبور داده می شود. عبور اغلب به صورت درصد گزارش می شود. جذب(A) طبق معادلهی زیر تعریف می شود.



شکل ۳ –۴ :دستگاه مدل Shimadzu uv- vis.1800 استفاده شده دز این پایان

به کمک طیف عبور و جذب اپتیکی و روابط فیزیکی وابسته، میتوان به برخی از خصوصیات ماده از جمله ضریب شکست، ضریب خاموشی، ضریب جذب، گاف نواری، دنباله نواری و همچنین ضخامت نمونه پی برد. تصویر دستگاه مدل Shimadzu uv- vis.1800 که در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته، در شکل ۳-۴ آورده شده است.

# ۳-۷- طیف سنجی تبدیل فوریهی فروسرخ

(۷-۳)

طیف سنجی تبدیل فوریهی فروسرخ یکی از پرکاربردترین روش ها در شناسایی کیفی مولکول های

 $A = -log_{10}^{T}$ 

**<sup>`</sup>Transmission** 

مختلف، تعیین ساختار مولکولی گونههای مختلف (مخصوصاً گونههای آلی) و شناسایی گروههای عاملی موجود در ساختار یک گونه میباشد. دستگاههای تبدیل فوریه (FT-IR) قادرند کل محدودهی طیفی را با استفاده از سیستم تداخل سنج به طور همزمان به نمونه تابانده و سپس آن را تجزیه و تحلیل نمایند. طیف سنجی فروسرخ بر اساس جذب تابش و بررسی قلههای ارتعاشی مولکولها و یونهای چند اتمی صورت می گیرد. این روش به عنوان روشی پر قدرت وتوسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه گیری گونههای شیمیایی، شناسایی ترکیبات آلی به کار میرود، زیرا طیفهای این ترکیبات معمولا پیچیده هستند و تعداد زیادی قلههای بیشینه و کمینه دارند که میتوانند برای اهداف مقایسهای به کار گرفته شوند. در مولکولها دو نوع ارتعاش وجود دارد که اصطلاحاً ارتعاشهای کششی<sup>۹</sup> و خمشی نامیده می شوند.

ارتعاش کششی به دو صورت متقارن<sup>۲</sup> و نامتقارن<sup>۳</sup> تقسیم بندی میشود. هرگاه یک نیم دوره ی تناوب ارتعاش کششی نامتقارن رخ دهد، گشتاور دو قطبی در یک جهت تغییر مییابد و در نیم تناوب دیگر، گشتاور دو قطبی در جهت مخالف جابه جا می گردد. بدین ترتیب گشتاور دو قطبی با بسامد ارتعاشی مولکول، نوسان مینماید. این نوسان باعث ارتقاء انرژی مولکول به نوار جذبی مادون قرمز می گردد، به همین علت آن را فعال فروسرخ مینامند. در حالت ارتعاش کششی متقارن، دو اتم در یک نیم تناوب ارتعاشی، در جهات مختلف حرکت می کنند که در این صورت تغییر نهایی در گشتاور دو قطبی مولکول به وجود نمی آید، به همین علت آن را غیر فعال مادون قرمز مینامند. در این حالت، تغییر در فواصل درون مولکولی، بر قابلیت قطبی شدن پیوندها اثر می گذارد. لذا در قطبش پذیری مولکول تغییر حاصل می شود و این حالتی است که در طیف سنجی رامان مورد توجه قرار می گیرد. بر مولکول تغییر حاصل می شود و این حالتی است که در طیف سنجی رامان مورد توجه قرار می گیرد. بر

<sup>&</sup>lt;sup>\</sup> Stretching

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> Symmetric

<sup>&</sup>lt;sup>*r*</sup> antisymmetric

روش مناسبی برای شناسایی گروه های عاملی و ساختار مولکولی است. شرط جذب انرژی فروسرخ توسط مولکول، طوری است که گشتاور دو قطبی در حین ارتعاش تغییر نماید. در طیف الکترومغناطیسی ناحیهی بین ۸٫۰میکرومتر تا πμ ۴۰۰ مربوط به ناحیهی فروسرخ است. ولی ناحیهای که جهت تجزیهی شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد، بین ۸٫۰ تا μm ۵۰ است. برای شناسایی کیفی یک نمونهی مجهول، نوع گروههای عاملی و نوع پیوندهای موجود در مولکول های آن، طیف فروسرخ نمونه را رسم نموده و با مراجعه به جداول مربوطه که موقعیت ارتعاش پیوندهای مختلف و طیف IR اجسام را نشان می دهند، طول موج یا عدد موج گروهها و پیوند ها را شناسایی می کنند.

برخی اطلاعاتی که میتوان از طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) بدست آورد شامل موارد: شناسایی کیفی و کمی ترکیبات آلی حاوی نانو ذرات، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن است [۲۸].در شکل ۳-۴ تصویر دستگاه FTIR مدل Rayleigh کشور چین،مورد استفاده در این پایان نامه آورد شده است.



شکل ۳-۴ : دستگاه تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR مدل Rayleigh کشور چین مورد استفاده در این پایان نامه

## **۲-۸-** رامان

طیف نگار رامان تکنیک طیف سنجی مولکولی است. هنگامی که تابش الکترومغناطیسی از محیط شفاف عبور میکند، گونههای موجود قسمتی از باریکه را در همه جهات پراکننده میکنند. در سال ۱۹۲۷ رامان کشف شد. طول موج مربوط به بخش کوچکی از تابش پراکنده شده توسط مولکولهای خاص با طول موج تابش اولیه تفاوت دارد، یعنی پراکندگی ناکشسان<sup>۱</sup> رخ داده است. میزان تفاوت در طول موجها با توجه به ساختار مولکولی ماده تغییر میکند. این طیف نگار براساس تجزیه و تحلیل این تفاوتها، ساختار مولکولی ترکیبات مختلف را تعیین میکند [۲۹]. شکل زیر دستگاه میکرو رامان مدل Raman-532-Ci



شکل ۳-۵ : دستگاه میکرو رامان مدل Raman-532-Ci با طول موج nm۵۳۲ استفاده شده در این پایان

# ۳–۹– حسگری گاز

تشخیص گازهای سمی و بخارهای آلی، برای محیط زیست و امنیت انسانی، برای کنترل انتشار، در بخش صنعت و تشخیص پزشکی دارای اهمیت بسیار است. پلیمرهای رسانا، نانولولههای کربنی و اکسید فلزی، در بسیاری از اشکال (لایهای ضخیم یا نازک، نانوذرات، نانوسیمها و غیره) به طور گستردهای برای

<sup>&#</sup>x27; inelastic scattering

حسگری گاز مورد استفاده قرار گرفته اند. حسگرهای گاز مقاومتی دستگاه الکترونیکی است که محور عملکرد آن برمبنای تغییرات مقاومت الکتریکی است. بنابراین، حسگرهای گاز مقاومتی برای تشخیص گازهای مختلف محیط و همچنین تغییر غلظت آنها مناسب هستند. برنامههای امنیتی و دفاعی داخلی کشورها به سیستمهای نظارتی قابل حمل برای سلاح شیمیایی سمی نیاز دارند. همچنین در مورد تشخیص مواد غذایی فاسد (و فعال کردن عملکرد نفس) و برای کشف بیماریهای بدون علامت از طریق تنفس است.در شکل ۳–۶ یک قطعهی حسگر را نشان میدهد که بطور کلی شامل: زیر لایه، لایه حساس تهیه شده، الکترودها و هیتر است. که در یک سیستم حسگری قرار دارد.



شکل ۳-۶: شماتیکی از حسگر گازی

عمکرد حسگر به شدت وابسته ساختار و ریخت شناسی لایه حساس است. یکی از موارد مورد توجه در ساخت قطعه حسگری با کارایی بالا، کاهش ابعاد اندازهی ذرات لایه حساس میباشد. با کاهش اندازه ذرات، نسبت حجم به سطح افزایش مییابد و مکانهای فعال جهت جذب و به دام انداختن مولکولهای گاز افزایش مییابد[۳۰]. در شکل۳-۷ تغییرات نوار رسانش نیمرسانا قطعه حسگری را زمانیکه حسگر در معرض هوا قرار می گیرد نشان داده است. مولکولهای O2 جذب سطحی لایه حسگر می شوند. به علت الکترون خواهی بالای اکسیژن، الکترونهای نوار رسانش لایه حساس را به دام می اندازند در نتیجه یونها اکسیژن ایجاد می شوند که باعث ایجاد خمش در نوار رسانش می شود. این خمش باعث ایجاد یک ناحیه ی خالی از الکترون که با ضخامت طول ناحیه خمش برابر است ایجاد می کند که با نام ناحیه بار فضای معرفی می شود و سپس مقاومت حسگر افزایش می ابد [۳۱].



شکل ۳–۷: طرحی از خمش نوار ،که انرژی نوار رسانش (Ec)، انرژی نوار ظرفیت(Ev)، انرژی تراز فرمی (Ef)، ضخامت لایه بار(Δ) و eV نشان دهندهی سد پتانسیل است[۳۱]

اکسیدهای فلزی، بهترین مشخصه ها از لحاظ پاسخ و حساسیت در میان دیگر مواد از خود نشان دادهاند. همچنین هزینه کم ساخت و سهولت آنها باعث استفاده به صورت گستردهای در زمینهی دستگاههای سنجش گازشده است. با این حال، سنسورهای گاز مبتنی بر اکسید فلز ها در برابر حرارت معمولا در دمای بالا ( بالاتر از ۱۰۰) کار میکنند، که منجر به مصرف انرژی زیادی میشوند ) نقص دیگری از سنسورهای گاز مبتنی بر اکسید فلز، عدم انتخاب گزینی آنها است [۹]. در تحقیقات انجام شده مشخص شده است که سنسورهای گاز مبتنی بر پلیمر قادر به کار در دمای اتاق (هستند، با این حال حساسیت آنها تحت تاثیر رطوبت نسبی قرار دارند و میتواند منجر به تخریب حسگری نیز شود. از این رو، تلاشهای تحقیقاتی زیادی در زمینه مواد جدید که قادر به شناسایی گازها در دمای اتاق و در شرایط محیطی استاندارد و انتخابی و حساسیت بالا صورت گرفته است.

ویژگیهای برجسته مورفولوژیکی گرافن و ویژگی الکترونیکی جذاب آن توجه پژوهشگران را در سراسر جهان را به خود جلب کرد. غلظتهای کوچک گازهای هدف که بر روی سطح گرافن جذب می شود می توانند تغییر قابل توجهی از مقاومت را در آن ایجاد کنند. مقدار ppm گاز هدف را با استفاده از فرمول (۱-۴) محاسبه شد.

$$ppm = \frac{v_g}{(v_g + v)} * 10^6$$

(۴-۱)

که 
$$v_g$$
 معرف حجم گاز مورد نظر و  $v$  حجم گاز هدف  $v$  حجم محفظه است.  $v_g$  از رابطه (۲-۴)  
گاز ایدآل محاسبه میشود که در آن R ثابت گازها، P فشار اتمسفر و T دمای محیط حسگری است. $Pv_g = nRT$ 

#### (4-7)

در رابطه ی بالا n عدد آووگادرو برابر با مقدار 
$$^{77}$$
  $10^{77}$  ذره در گاز است. برای محاسبه جرم  $N$  خر رابطه ی بالا n عدد آووگادرو برابر با مقدار  $M$  جرم مولی گاز هدف و m جرم گاز است.  $n = \frac{M}{\mu}$ 

(۴-۳)

در شکل (۳–۸) نمای از دستگاه حسگر گازی مورد استفاده در این پایان نامه را نشان می دهد. برای سنجش ابتدا با ید غلظت گاز برحسب ppm محاسبه شود. عملکرد حسگر را می توان برحسب پارامترهای مختلف از جمله حساسیت، زمان پاسخ، زمان برگشت و غیره بدست آورد. حساسیت کوچکترین غلطت گاز هدف است که می توان در زمان تشخیص سنجیده شود که بصورت  $\frac{R_a}{R_g}$  تعریف می شود:

$$s = \frac{R_a - R_g}{R_a} * 100 \tag{f-r}$$

در شکل ۳-۸ شماتیکی از دستگاه حسگری دست ساز مورد استفاده در این پایان نامه مشاهده می

شود.



شکل ۳-۸ : دستگاه دست ساز حسگری گازی دانشگاه صنعتی شاهرود استفاده شده در این پایان نامه

## ۴-۹- جمعبندی

در این فصل به بررسی و مطالعهی انواع دستگاههای آنالیز شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف نگار نوری (UV-Vis)، طیف نگار رامان (Raman)، طیف نگار تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، بحسگر گازی و روش سنتز آب گرمایی اشاره شد. همچنین روابط لازم برای تحلیل دادهای بدست آمده بیان شد.

فس جهارم

مایچ تحربی و بحث

#### ۴–۱– مقدمه

در این فصل نتایج حاصل از پژوهشهای آزمایشگاهی، بحث و تحلیل دادهها، گردآوری شده است. ابتدا به سنتز اکسید گرافن کاهش یافته با استفاده از روش هامرز بهبود یافته و سپس کاهش آن با دو روش حرارتی و شیمیایی و نهایت تهیه کامپوزیت بر مبنای گرافن اشاره میشود. همچنین کابرد حسگری گازی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، نتایج اندازه گیریهای مورد نظر برای بررسی خواص ساختاری، مورفولوژی و نوری نمونهها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

بخش اول فعالیتهای آزمایشگاهی مربوط به سنتز اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته شیمیایی و حرارتی در دمای ۳۰۰ و C<sup>o</sup> ۹۰۰ و نانو کامپوزیت برمبنای اکسید گرافن کاهش یافته است که جهت بررسی خواص حسگری مورد بحث قرار گرفتند. در بخشهای بعدی به بررسی آنالیزهای بدست آمده از نمونهها و در ادامه به مقایسه دو روش کاهش اکسید گرافن پرداخته شده است.

در نهایت حسگری یکی از نمونههای اکسید گرافن کاهش یافته و کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دی سولفید مولیبدن مورد مطالعه قرار گرفت. حسگری نمونه ها در دمای اتاق و دمای ۲۰۰° انجام شد. حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونهها در دو دمای سنجش محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.

## ۲-۴ سنتز اکسید گرافن با استفاده از روش هامرز بهبود یافته

مواد مورد استفاده در این پژوهش از شرکت مرک با درصد خلوص آزمایشگاهی تهیه شده است.در جدول ۴-۱ لیست مواد مورد استفاده در این پژوهش و مقادیر آنها برای یک بار سنتز به همراه فرمول شیمیایی آنها بیان شده است.

مقدار	فرمول شيميايى	مواد مورد استفاده
۰/۳ gr	С	<i>گ</i> رافیت
۱/۸ gr	KMnO <sub>4</sub>	پتاسیم پرمنگنات
۳۶ ml	$H_2SO_3$	اسيد سولفوريک
۴ml	H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	اسيد فسفريک
۴۰ ml	H <sub>2</sub> O	آب ديونيزه يخزده
۱۰۰ml	HCl	اسید هیدروکلریک ۱۰٪
۲/Yml	$H_2O_2$	آب اکسیژنه ۳۰٪
۲/Yml	N <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	هیدرازین هیدرات ٪۸۰
•/\ <b>\</b> Yg	$CH_4N_2S$	تيوره
. /۲۱۱g	((NH4)6M07O24.4H2O)	آمونيوم هپتا موليبدات تترا هيدرات
7.1(w)	CaCL	كلسيم كلريد

جدول ۲- ۱: مواد مورد استفاده در تهیه نمونهها

در این پایان نامه سنتز اکسید گرافن به روش هامرز بهبود یافته انجام شد[۱۴و۷و ۱۸]. ابتدا محلولی از اسید سولفوریک m ۳۶ و اسید فسفریک m ۴ را به نسبت حجمی (۱:۹) تهیه شد. پودر گرافیت به آرامی به محلول بالا اضافه گردید تا بصورت کامل حل شود. پتاسیم پرمنگنات (KMnO4) را به آرامی در مدت ۱ ساعت با کنترل دما در محدودی C<sup>°</sup> ۲۰ اضافه گردید و در صورت افزایش بیش از حد دما، از حمام یخ استفاده گردید. محلول به مدت ۳ شبانهروز برای کامل شدن واکنش بروی هم زن قرار گرفت. رنگ محلول بعد از گذشت ۳ روز از سیاه به رنگ مسی تغییر یافت.

 $m H_2O_2$  سپس، هیدروژن پراکسید ( $m H_2O_2$ ) به آرامی به محلول اضافه گردید در حین اضافه کردن  $m H_2O_2$ افزایش دما با اضافه کردن قطعات یخ زدهی آب مقطر کنترل می گردد. سپس محلول حاصل جهت حذف یونها و اسیدهای اضافی به صورت کامل با آب مقطر و HCl با استفاده از سانتریفیوژ چندین بار شستشو شد. مرحله شستشو اهمیت بسیاری دارد. در نهایت محلول قهوهای تیره نهایی به مدت ۹۰ ساعت در دمای ۲۰°۷ خشک سازی شد. در این مرحله اکسید گرافن تهیه میشود. پودر اکسید گرافن در زیر دستگاه پرس به قرص تبدیل شد و مقاومت الکتریکی آن با دستگاه پروب چهار سوزنی بررسی گردید که رسانندگی نمونه اکسید گرافن صفر اندازه گیری شد. این کار با گزارش دیگران در تطابق است [۱۴ و ۱۸].



شکل ۴ – ۱: طرحوارهی از سنتز اکسید گرافن با استفاده از روش هامرز تهیه شده در این پایان نامه

# ۴-۶- مشخصه یابی اکسید گرافن

۴–۶–۱– طیف نگار تبدیل فوریه مادون قرمز

آنالیز طیف نگار مادون قرمز به عنوان یک روش پر قدرت برای تعیین ساختار و شناسایی ترکیبات آلی، پیوندهای شیمیایی و گروههای عاملی و ساختار مولکولی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این گزارش هدف از انجام این آنالیز، شناسایی گروههای اکسیژندار ایجاد شده بعد از اکسایش در نانو ورقهها GO است. همانطور که در شکل ۴–۲ مشاهده میشود. بیشتر مولکولهای آلی در محدود ۲۰۰۰ تا <sup>1-</sup> ۴۰۰۰ cm<sup>-1</sup> ارتعاش دارند. که در واقع علت آب دوستی نانو ورقههای هیدروکسیل در محدوده ناحیه گروه هیدروکسیل (O-H) موجود در این محدوده است. پیوندهای هیدروکسیل در محدوده ناحیه آب وگرافیت میشود که حضور این قله ماهیت آب دوستی نمونه را مشخص میکند. همچنین وجود آب وگرافیت میشود که حضور این قله ماهیت آب دوستی نمونه را مشخص میکند. همچنین وجود



شکل ۴ –۲ – طیف مادون قرمز نمونه GO تهیه شده با استفاده از روش هامرز

در طیف GO، حضور قلههای هیدورکسیل در <sup>1</sup>-۳۴۱۵ cm و اپوکسی در <sup>1-</sup> GO، حضور قلههای هیدورکسیل در <sup>1-</sup> ۳۴۱۵ cm سطح ورقهها قرار می گیرند مشاهده می شود. همچنین گروههای اکسیژن دار کربونیل با قله جذبی <sup>-</sup>cm ۱۰۴۷<sup>1</sup> و کربوکسیل با قله جذبی <sup>1</sup>-۱۷۲۲cm که در لبهی وجود دارند، ظاهر شد. که این نشان دهندهی اکسایش موفقیت آمیز گرافیت است [۱۳و۲۲].

كربونيل	اپوكسى	گرافیتیSp <sup>2</sup>	كربوكسيل	هيدروكسيل	GO
C-0	С-О-С	C=C	C=O	O-H	پيوند
1.44	١٢١٩	1814	١٧٢٢	2613	پیک جذبی
لبه	سطحى	اكسيدنشده	لبه	سطحى	محل پيوندها

جدول ۴-۲: گروههای اکسیژن دار ایجاد شده در GO تهیه شده باروش هامرز

## ۴-۶-۲ طیف نگار رامان اکسید گرافن

طیف نگار رامان یک ابزار قدرتمند برای بررسی ساختار و کیفیت ذاتی نانو کربنهای از قبیل نانو تیوپهای کربنی و گرافن است. طیف رامان نمونه اکسید گرافن در شکل زیر دو قله اصلی را نشان میدهد. قله نوار D که تقریبا در  $^{-1}$  ۱۳۵۰  $m^{-1}$  قرار دارد و ناشی از حالت تنفسی حلقههای آروماتیک نشان دهندهی عیوب و نقایص ساختاری از اتصال گروههای اکسیژندار در شبکهی کربنی  $sp^3$  است. همچنین قله نوار G در  $^{-1}$  ۱۵۸۵ که مشخصهی پیوندهای کربن – کربن با هیبریداسیون  $sp^2$  می-باشد، که از پراکندگی مرتبهی اول از حالتهای فونون دوگانهی تبهگن شدهی( $E_{2g}$ ) گرافیت در مرکز منطقهی بریلیون و نیز پیوند کششی جفتهای کربنی  $sp^2$  در حلقهها و زنجیرهها ناشی میشود دانست. بطور کلی شدت نوار D به G بسیار مهم است از جمله بیانگر میزان اکسایش نمونه خواهد بود [۱۷<sub>9</sub>۳۲].


Raman shift (cm -1)

شکل۴-۳: طیف رامان (GO) تهیه شده با روش هامرز بهبود یافته در این پایان نامه

# 4-8-۳- ویژگی های اپتیکی طیف جذب UV-Vis

طیف مادون قرمز – فرابنفش برای بررسی انتقال و جذب استفاده شد. GO باتوجه به ویژگی آب دوستی با نسبت وزنی مشخص در ۱۰ ml آب مقطر ۳ بار تقطیر شده و با استفاده از ارتعاشات التراسونیک حل گردید و از محلول آنالیز گرفته شد.



شکل ۴ – ۴– طیف جذب نمونه GO تهیه شده با استفاده از روش هامرز

همانطور که در شکل ۴-۴ مشاهده می شود، GO دارای ۲ قله جذب در ۲۵۷ و ۳۹۱nm است. قله موجود در ۲۵۷ nm مربوط به پیوند C-C است و قله دیگر در حدود ۳۹۰nm مربوط به C=O است. در شکل۴-۴ طیف جذبی UV-Vis نشان داده شده است. همچنین جهت محاسبه گاف نواری نمودار ۴-۴-ب رسم شد. نمونه اکسیدگرافن eV ۲/۵ را به خود اختصاص داد.

## ۴-۶-۴ الگوی پراش پر تو ایکس

دستگاه تحلیل پراش پرتو ایکس (XRD) یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی و بررسی خواص بلوری، فاصله بین لایهها، اندازه بلورک ها و تکمیل فرآیند واکنش است. در شکل۴–۵ الگوی پراش پرتو ایکس برای گرافیت و اکسیدگرافن نمایش داده شده است. قله بلورین شش گوشی گرافیت زاویه <sup>o</sup> ۲۶/۶ و در راستای (۰۰۲) ثبت شده است که نشان دهندهی فاصلهی صفحات (d) گرافن مقداری در حدود nm ۰/۳۷ نشان میدهد.

همانطور که مشاهده می شود پس از اکسایش گرافیت قله مربوط به گرافیت حذف و قله پراش جدیدی در حدود ۲۰<sup>°</sup>۱۱ و در راستای صفحات (۰۰۱) ایجاد شده است. قله جدید نشان دهنده ی فاصله صفحات در حدود nm ۲/۶۳ است که روند تغییرات بیان کننده ی قرار گرفتن گروههای عاملی اکسیژن-دار مانند: اپوکسی، کربونیل، هیدورکسیل، کربوکسیل و غیره در لایه لایه صفحات و افزایش نقایص ساختاری پیوند Sp<sup>3</sup> ورقههای گرافیت و در نهایت منجر به افزایش فاصله نانو ورقههای گرافیتی شده است. این تغییرات نشان دهنده ی موفقیت آمیز بودن اکسایش گرافیت است [۱۰۹۸و۲۰۰].

هدف از انجام اکسایش بیشتر کردن فاصله بین صفحات دو بعدی با ساختار شش ضلعی جهت بدست آوردن گرافن است که در این مرحله فاصلهی صفحات از یکدیگر بیشتر شده است.



شکل ۴-۵- الگویی پراش پرتو ایکس (الف) پودر گرافیت (ب) اکسید گرافن تهیه شده با روش هامرز

۴–۶–۵– ریخت شناسی اکسید گرافن

در شکل (۴–۶) تصاویر میکروسکوپی نانو ورقههای اکسید گرافن در مقیاسهای مختلف نشان داده شده است. ورقههای گرافنی بصورت فشرده و با فاصله بسیار نزدیک در گرافیت بروی هم انباشته شده اند که بعد از واکنش اکسایش به علت قرار گرفتن گروههای اکسیژن دار در بین صفحات فاصلهی این ورقههای دو بعدی از یکدیگر بیشتر شده است [۱۷و ۱۸ و ۳۲].



شکل ۴ – ۶: تصاویر ریخت شناسی نمونه GO در مقایسهای الف)۱۰µm ب)۵۰µm ج)۸۰۰ nm د)

EDX طيف نگار

در شکل 4 - 7 تجزیه و تحلیل عناصر مختلف نمونهها با طیف نگار EDAX ثبت شد در نمونهی GO حضور عنصر کربن مربوط به ساختار کربنی گرافیت است. همچنین عنصر اکسیژن بعد از فرآیند اکسایش گرافیت، با صفحات گرافیت پیوند تشکیل میدهند و در ساختار صفحات به عنوان یک نقص حضور پیدا میکنند. با اندازه گیری قلهها نسبت وزنی عنصر C به O برابر 9/9, و نسبت اتمی آنها برابر با ۱/۲۸ است.



شكل ۴-۷ : الگويي EDAX نمونهGO

۴–۳– سنتز اکسید گرافن کاهش یافته (RGO) با روش حرارتی و بررسی تاثیر دما و بهبود کاهش با مایکرویوو

کاهش حرارتی اکسید گرافن یک روش کارآمد در جهت تولید پودر RGO با کارایی بالا میباشد. در این روش زمانیکه اکسیدگرافن تحت دماهای بالا قرار می گیرد مولکولهای آب و اکسیژن موجود در بین و لبهی صفحات از بین میروند و فرآیند کاهش رخ میدهد [۸]. روش سنتز اجرا شده برمبنای پژوهش دامیان وایری و همکارانش می باشد [۳۵].

قبل از انجام عملیات کاهش GO لایه لایه گردید به این طریق که محلولGO (۵٫۷ میلی گرم بر میلی گرم) بدست آمده در بخش قبلی را با نرخ مشخص ۰/۱ ml/min ۰/۱ به محلول کلسیم کلرید (CaCL2) آبی ۱٪ وزنی با هدف ایجاد حمام انعقاد و لایه لایه کردن اکسید گرافن اضافه گردید. بعد از انجام لایه برداری اکسید گرافن، محلول حاصل را در دمای اتاق جهت خشک سازی قرار گرفت.



شکل ۴- ۸ – الگویی از مراحل سنتز اکسید گرافن کاهش یافته(RGO) با روش حرارتی در دو دمای مختلف ۳۰۰ و ۲۰۰۰ و بهبود کاهش با ماکرویوو

برای تهیه اکسید گرافن کاهش یافته RGO پودر اکسید گرافن لایه به لایه شده را با روش حرارتی زیر کاهش یافت. پودر در دمای ۲۰۰۵ در خلا تحت اتمسفر با گاز Ar به مدت ۱ ساعت قرار گرفت و عملیات کاهش به صورت خفیف انجام میشود همچنین آهنگ رسیدن به دما و کاهش دما ۱ ساعت و شار گاز آرگون در ۲۰۰ تثبیت شد. برای بهبود کاهش پودر حاصل تحت اشعه ماکروویو برای ۱۰ دقیقه با توان ۲۰۰ و دمای ۲۵۰۰ درجه قرار گرفت و در نهایت GO به RGO تبدیل شد (شکل ۴-۸). فرآیند کاهش مشابه روش بالا را برای دمای ۲۰۰۰ انجام میدهیم. نمونهی بدست آمده در ۲۰۰۰ و ۹۰۰ به ترتیب با Mw-RGO 300 و Mw-RGO انجام میدهاری شد (۳۵ ۴-۴- مشخصه یابی اکسید گرافن کاهش یافته به روش حرارتی

۴-۴-۱- طیف نگار تبدیل فوریه مادون قرمز

در شکل۴–۹ طیف تبدیل فوریه مادون قرمز نمونه و اکسید گرافن کاهش یافته نشان داده شده است. گروههای اکسیژنی موجود در ساختار اکسید گرافن و اکسید گرافن کاهش یافته در جدول زیر به صورت خلاصه بیان شده است. در شکل زیر حضور قلهی <sup>1-</sup> ۲۷۲۵ m ایان کنندهی پیوند کششی میان کربن و اکسیژن O=C است که بعد از فرآیند کاهش GO به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. پهنای قلهی ۳۴۱۵ که مربوط به پیوندهای هیدروکسیل است کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده کاهش شدید آب دوستی نمونهها است. همچنین قلههای ۱۰۴۷ و ۱۲۱۹ و <sup>1-</sup>۱۷۳۱ اکسید گرافن بعد از فرآیندکاهش تقریبا حذف شده اند.



شكل ۴- ۹: الكوى طيف نكار نمونه هاى الف) GO ب) MwRGO300 ج) MwRGO300 ج

در نمونه Mw-RGO 900 نسبت به نمونهی Mw-RGO 900 بیشتر بوده است که نشان دهندهی موثر بودن دما بر فرآیند کاهش است [۱۲و۱۷].

	هيدروكسيل	كربوكسيل	گرافیتیSp <sup>2</sup>	اپوكسى	كربونيل
پيوند	O-H	C=O	C=C	С-О-С	C-0
پیک جذبی GO	8410	١٧٢٢	1814	١٢١٩	1.47
طيف جذب RGO-300	۳۴۲۷	حدف	1814	حدف	حدف
طيف جذب RGO-900	341.	حدف	1820	حدف	حدف
محل پيوندها	سطحى	لبه	اکسیدنشدہ	سطحى	لبه

جدول ۴-۳: گروههای اکسیژندار باقی مانده بروی صفحات گرافنی بعد از کاهش GO

## ۴-۷-۲- طیف سنج رامان

همانطور که در بخشهای قبلی اشاره شد نسبت (I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub>) نشان دهندهی میزان حضورگروههای اکسیژندار در شبکه کربنی است که با افزایش این نسبت عیوب شبکه کربنی کاهش مییابد. همانطور که در شکل (۴–۱۰) مشاهده میشود نسبت شدت قلهها در نمونهی MW – RGO 900 – MW برابر با ۱/۳۴ و در نمونهی 300 RGO – MW برابر با ۱۹۸۶ است که در مقایسه با GO که مقدار ۱۹۶۹ اندازه گیری شده است، افزایش یافته است. با توجه به جدول ۴–۴ میتون به اثر مهم دما در فرآیند کاهش اکسیدگرافن پی برد [۱۴و۳۳].

افزایش دما نسبت شدت قله باند D به پیک G افزایش یافته است که نشان دهندهی بهبود حذف عیوب (گروههای عاملی) و بازیابی ساختار کربنی شبکه SP<sup>2</sup> میباشد[۳۴]



شکل ۴- ۱۰ : مقایسه طیف رامان نمونه های اکسید گرافن با اکسید گرافن کاهش یافته به روش حرارتی

جدول ۴ – ۴ ۱مقایسه نسبت شدت قلههای اکسید گرافن با اکسید گرافن کاهش یافته با روش حرارتی در دو دمای ۳۰۰ و ° ۹۰۰

نمونه	
GO	•/٩۶٩
RGO -T – 300	•/٩٨۶
RGO -T – 900	1/84

۴-۷-۳ ویژگی های اپتیکی UV-vis

در شکل ۴–۱۱ طیف جذب اکسید گرافن کاهش یافته در دمای ۳۰۰ و C<sup>o</sup> ۹۰۰ نشان داده شده است. بعد از کاهش حرارتی قله ۲۴۰ nm به سمت طول موج بیشتر انتقال پیدا کرده است و قله nm ۳۸۳ تقریبا حذف شده است. این انتقال نشان دهندهی حذف گروهای اکسیژندار و بازسازی حلقههای آروماتیک در صفحات گرافنی است که تبدیل موفقیت آمیز اکسید گرافن به اکسید گرافن کاهش یافته را نشان میدهد. از مقایسه انتقال قله ۲۴۰nm به سمت طول موج های بیشتر درنمونه MW – RGO 300 و MW – RGO 900 – MW تاثیر دما بر بهبود فرآیند کاهش مشخص شد.که نشان دهندهی موثر بودن افزایش دما بر بهبود فرآیند کاهش ست [۱۹ه۸].



Wavelength (nm)

شكل ۴- ۱۱ : طيف جذب نمونه هاى GO و 900 MW - RGO و 100 - MW و 300 MW

۴-۷-۴ تحلیل پراش پرتو ایکس

مطابق با گزارشات در آنالیز اکسید گرافن کاهش یافته قله بزرگ در زاویه حدود <sup>°</sup>۲۷ مشاهده معافد میشود که متناسب با فاصله صفحات تقریبا A<sup>°</sup> ۵۷/۰است. که این فاصله در اکسیدگرافن کاهش یافته بیشتر از اکسیدگرافن است.



شکل ۴ – ۱۲ : الگوی پراش پرتو ایکس برای نمونه های Mw – RGO 300 و Mw – RGO 900 و

در شکل ۴–۱۲ مشاهده می شود قله مربوط به اکسید گرافن که درصفحات (۰۰۱) قرار داشت دیده نمی شود، که نشان دهندهی حذف گروه های اکسیژن دار و تشکیل اکسید گرافن کاهش یافته و لایه لایه شدن نانو ورقه ها است.

شدت قله در نمونه Mw – RGO 900 بیشتر از نمونهی Mw – RGO 300 است که نشان دهندهی حذف بهتر گروههای اکسیژن دار نسبت به نمونه ۳۰۰° است. درجدول ۴–۵ زاویه، راستای صفحات و فاصلهی بین صفحات در فرآیند تبدیل گرافیت به اکسید گرافن کاهش یافته بیان شده است [۲۰٫۱۷۰۱۵].

چگالی درفتگی و کرنش نمونهها در جدول زیر محاسبه شده است. در نمونهی 900 – T - 900 پ نسبت به نمونهی 300 – T - RGO چگالی در رفتگی و کرنش کاهش یافته است. کاهش عیوب در نمونهی RGO – T – 900 نشان دهندهی از حذف مقدار زیادی از گروههای اکسیژن دار موجود در بین و لبهی نانو صفحات گرافنی است و همچنین اثر مهم دما بر فرآیند کاهش و نزدیک شده به ویؤگیهای شبه گرافن است.

	G	GO	RGO – 300	RGO – 900
زاويه	78°	۱۱۰	۲۳/۹۴۰	78°
راستای صفحات	(••1)	(••٢)	(•••)	(•••)
اندازہی بلورک	4/3121	1/94+2	٩/٣٨٩٨	<b>۳/</b> λ۶۷λ
چگالی درفتگی	•/•۵۳۷	•/• ) ) ٣	•/४۶۵٧	•/•۶۶٨
كرنش	۸/۱۰۳۳×۱۰ -۳	٣/۶٩١ ×١٠ -٣	•/• ١٧٩	۸/۹۶۲۱×۱۰ -۳

جدول ۴ -۵: مقایسه راستای اندازه بلورک، چگالی در رفتگی و کرنش نمونهها ی تهیه شده

۴–۷–۵ ریخت شناسی

شکل۴–۱۳و ۴–۱۴ تصاویر ریخت شناسی از نانو صفحات دو بعدی 300 Mw – RGO و Mw – Mw و - Mw و ۳ Mw - RGO و ۳ RGO 900 را در مقایسههای ۱۹۳۸، ۵۰µm، ۵۰µm و ۵۰۰ نشان میدهد. همانطور که تصاویر نشان میدهد صفحات اکسید گرافن کاهش یافته روی هم انباشته شدهاند.

علت چروک بودن صفحات وجود گروههای فعال اکسیژندار مانند اپوکسی، هیدروکسیل، کربونیل، کربوکسیل است. نتایج بدست آمده مشابه کار مقالات است [۸،۱۷و۳۲].



شکل ۴ –۱۳ : تصاویر ریخت شناسی نمونه GO 300 Mw – RGO تصاویر ریخت شناسی نمونه GO در مقایسهای الف)۱۳۷ ب)۱۰۰ mm ج)۱۰۰ ه)



شکل ۴ –۱۴ : تصاویر ریخت شناسی نمونه GO Mw – RGO 900 تصاویر ریخت شناسی نمونه GO در مقایسهای الف/۱µm ب)۱۰۰ mm ج)۱۰۰ nm د)۱۰۰ م

### EDX - 9- 9- 4- طيف نگار

شکل ۴–۱۵ طیف نمونه ی 300 MW-RGO و 300 MW-RGO نشان می دهد. عنصر اکسیژن بعد از فرآیند کاهشGO تحت حرارت، کاهش یافته است که نشان دهنده ی کاهش نقایص ساختاری نمونه ها است. نمونه ی 300 MW-RGO با اندازه گیری قله ها نسبت وزنی C به O برابر ۲/۲۹ و نسبت اتمی آن ها برابر با ۲/۰۲ است. همچنین در نمونه ی MW-RGO 900 نسبت وزنی برابر ۳/۷۳ و نسبت اتمی ۱۰/۲۹ است. در مقایسه ی نسبت اتمی و وزنی نمونه MW-RGO 900 بیشتر است که نشان دهنده ی موثر بودن دما بر فرآیند کاهش می باشد.



شكل ۴ – 1۵: آناليز EDAX نمونهي الف) MW-RGO 300 و ب) MW-RGO 900

۴-۷-۴ اندازه گیری جریان ولتاژ (I-V)

در شکل ۴–۱۷ تغییرات جریان بر حسب ولتاژ (منحنیI-V) برای نمونهها در دمای اتاق تحت MW-RGO 300 روشنایی رسم شده است. که نمونه MW-RGO 900 از رسانندگی بالاتری نسبت به 300 MW-RGO 900

برخورد دار است. در شکل ۴–۱۷ تقارن و خطی بودن نمودارها نشان دهندهی اتصال اهمی در نمونهها است. با استفاده از شیب منحنی جریان – ولتاژ می توان مقاومت و رسانندگی نمونهها را محاسبه کرد.



شكل ۴- 18 : نمودار جريان – ولتاژ نمونه 300 MW-RGO و 900 MW-RGO و MW-RGO

# ۴-۵- ساخت نمونه حسگری

برای ساخت نمونه حسگری mg ۰/۵ mg از پودر اکسید گرافن کاهش یافته بصورت قرصی با ضخامت مشخص تهیه شد. با استفاده از چسب نقره الکترود گذاری آن صورت گرفت. نمونه درون محفظهی با حجم مشخص قرار گرفت و در دمای اتاق (RT) و ۲۰۰۲ سنجش گاز هدف انجام گرفت.

با ورود گاز هدف به داخل ظرف مقاومت نمونه به مدت ۲۰ دقیقه افزایش یافت و بعد از ثابت شدن مقاومت جهت خروج گاز هدف از داخل ظرف از گاز بی اثر نیتروژن N<sub>2</sub> به مدت ۲۰ دقیقه استفاده شد تا مقاومت نمونه به همان مقدار اولیه برگردد. مقدار غلظت گاز هدف برحسب ppm با استفاده از فرمول بیان شده در فصل سوم محاسبه شد.



شکل ۴-۱۷: طرحواره ی از نمونه حسگری ساخته شده

شکل۴–۱۷ طرحوارهی از قطعه حسگری ساخته شده از RGO را نشان میدهد. نمونه در محفظه مخصوص حسگری با حجم مشخص قرار گرفت. سپس با تزریق کردن غلظتهای مختلف حسگری نمونه بررسی شد. همچنین از گاز N<sub>2</sub> جهت بازیابی حسگر استفاده گردید.

# ۴–۵–۱– حسگری گازی

حسگری گازی به روش مقاومت سنجی انجام گرفت. ابتدا قرص به الکترود متصل میشود. برای غلظتهای بیان شده تغییرات مقاومت را بررسی می کنیم. برای انجام حسگری گازی نمونهی ۹۰۰ MW RGO – به علت دارا بودن رسانندگی بیشتر انتخاب شد. همانطور که مشاهده میشود در هر دو دما با افزایش غلظت گاز، حساسیت افزایش مییابد. حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه در دو دما نشان داده شده است. با در معرض قرار دادن ناحیه سطحی حسگر نسبت به گاز آمونیاک در دمای ۲۰۰۰، پاسخ گاز با افزایش غلظت گاز از ۱۰۰ تا Moroph به ترتیب از ۱۶/۱۰ ٪ به ۲۲/۱۰٪، در دمای حسگری اتاق پاسخ گاز به ترتیب از ۱۳۷۷ ٪ به ۲۲/۳ ٪ افزایش یافته است.

شکل ۴–۱۸ و ۴–۱۹ نمودار تغییرات مقاومت نمونه حسگری 900 MW – RGO را برای گاز آمونیاک در غلظتهای ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ppmدر دمای اتاق و دمای ۲۰۰۲ نشان میدهد. جدول ۴–۶ و ۲-۴ حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه را در هر دو دما نشان میدهد [۱۵].



Time (s)

شکل۴ – ۱۸ : نمودار حسگری گازی آمونیاک برای نمونه Mw – RGO 900 در دمای C°۰۰

جدول ۴ – ۶ : تغییرات مقاومت، حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه Mw – RGO 900 نسبت به غلظتهای مختلف گاز آمونیاک در دمای حسگری C۰۰<sup>°</sup>

Mw-rgo	تغييرات مقاومت(ohm)	حساسيت(%)	زمان پاسخ (s)	زمان ریکاوری(s)
T=RT				
۱۰۰ppm	۶/۲	۰/۶۱	١٩	۵۷۸
۲۰۰ppm	۹ /۵	٠/٩۵	1/221	١٣١٩
۵۰۰ppm	۱۴ /۸۸	14/21	٨٢٠	77.8
۱۰۰۰ppm	31/47	31/80	۸۸۶	١٢٩٩
۱۵۰۰ppm	42/22	47/•4	۴۵۹	١٣٨٢



Time (s)

شکل۴ – ۱۹ : نمودار حسگری گازی برای نمونه Mw – RGO 900 در دمای اتاق

جدول ۴- ۲: تغییرات مقاومت، حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه Mw – RGO 900 نسبت به غلظتهای مختلف گاز آمونیاک در دمای اتاق

MW-RGO	تغييرات مقاومت(ohm)	حساسيت(٪)	زمان پاسخ (s)	زمان ریکاوری(s)
T=100				
۱۰۰ppm	۴/۲۷	١/٣٧	17	262
۲۰۰ppm	۶/۲۵	۲/۱۳	۵۳۴	۷۸۵
۵۰۰ppm	۱۱/۲۵	٣/٩٢	811	۳۰۹
۱۰۰۰ppm	14/24	۵/۰ ۱	817	10.0
۱۵۰۰ppm	८•/७८	۶/۵	777.	١٧٣۴
۲۰۰Ppm	۵/۲	۱/• V	۲۳۹۶	۵۵۳

با افزایش غلظت گاز از ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ppm ، سطح بزرگتری توسط مولکولهای گاز هدف جذب شده و به همین علت واکنشهای سطحی بر روی سطح لایه حسگر افزایش و در نتیجه پاسخ نسبت به گاز هدف افزایش مییابد[۳۶]. در شکل ۴–۲۰ نمودار تغییرات حساسیت بر حسب غلظتهای مختلف نشان داده شده است.



شكل ۴- ۲۰ : نمودار تغييرلت حساسيت با افزايش غلظت نمونه Mw – RGO 900 الف) در دماى اتاق ب) دماى ٥

۴-۶- سنتز اکسید گرافن کاهش یافته با روش شیمیایی

در شکل ۴–۲۱ طرحوارهی از روش کاهش شیمیایی GO نشان داده شده است. کاهش GO با استفاده از هیدرازین هیدرات (No (N<sub>2</sub>H4) کریداری شده از شرکت مرک که بعنوان یک کاهش دهنده ی قوی و سمی شناخته شده است انجام گرفت.



شکل ۴- ۲۱ - طرحوارهی از مراحل تهیه اکسید گرافن کاهش یافته با روش شیمیایی در این پایان نامه

ابتدا T۰۰ ml نانو ورقههای GO در GO در ۱۰۰ آب پراکنده شد و به مدت ۱ ساعت در دمای اتاق بر روی التراسونیک جهت ایجاد پراکندگی بهتر قرار گرفت. محلول مورد نظر در دا خل بالن قرار داده شد و مطابق شکل با اضافه کردن ۱ ml هیدرازین هیدرات و قرار دادن در دمای C<sup>o</sup> ۱۰۰ به مدت ۲۴ ساعت تحت سیستم رفلاکس فرآیند کاهش انجام شد.

پس از اتمام واکنش کاهش، محصول بدست آمده با آب مقطر شتشو داده شد و در دمای  $^{\circ}$  ۶۰ خشک شد. انتخاب پارامترها و روش رشد مبتنی بر مقالات دیگران انجام شد. نمونه بدست آمده در این مرحله RGO – H نامگذاری شد [۱۷].

۴-۷- مشخصه یابی اکسید گرافن کاهش یافته به روش شیمیایی

۴-۷-۱- طیف نگار مادون قرمز

در شکل ۴-۲۲ طیف دو نمونهی اکسیدگرافن و اکسید گرافن کاهش یافته به روش شیمیایی مشاهده می شود. با مقایسه الگوهای اکسید گرافن با اکسید گرافن کاهش یافته قلهای در <sup>۱</sup>-۱۷۲۲ cm در نمونه GO وجود دارد و نشان دهندهی پیوند کششی C=O است بعد از کاهش به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین شدت و پهنای قله <sup>۱</sup>-۳۴۱۵ cm کاهش یافته است. دیگر قلههای گروههای اکسیژن دار تقریبا از بین رفتهاند که نشان دهندهی کاهش اکسید گرافن بوده است [۲۰و۳].



شکل ۴ – ۲۲ : طیف نگار مادون قرمز RGO – H

۴-۷-۴-طیف سنج رامان اکسید گرافن کاهش یافته با روش شیمیایی

همانطور که درشکل ۴–۲۳مشاهده می شود قلههای باند D همانطور که تقریبا در  $cm^{-1}$ مشاهده می شود قلههای باند G و قلههای و مانطور که در G - H ماهر شده است. نسبت شدت قله باند D و G به قله باند G برابر با

۱/۱۸ است نسبت به GO افزایش داشته است که بیان کنندهی انجام فرآیند کاهش است. از مقایسه سه نمونهی کاهش یافته نمونهی RGO – T – 900 بیشترین مقدار نسبت را داشته است [۳۴].



شکل ۴ – ۲۲ : طیف نگار رامان RGO – H

RGO - H و MW-RGO 900 و MW-RGO 300 و MW-RGO 1 و MW-RGO 900 و MW-RGO 900 و

نمونه	<i>I<sub>D</sub>/<sub>IG</sub></i>
GO	•/ <b>٩</b> ۶٩
RGO -T – 300	•/ <b>٩</b> <i>\</i> ۶
RGO -T - 900	1/84
RGO - H	۱/۱۸

# ۲−۷−۴ ویژگی اپتیکی الگوی مادون قرمز UV

در شکل ۴–۲۴ یک قله جذب در حدود ۳۸ ۲۶۰ برای نمونه RGO – H نشان داده شده است. GO دارای قلههای جذب در ۲۴۰ nm ۲۴۰ مربوط به پیوند C-C و در حدود ۳۹۰ m مربوط به C=C است. بعد از کاهش شیمیایی قله اول از ۲۴۰ nm ۲۴۰ به طول موج ۲۶۰ nm ۲۶۰ انتقال یافت و قله دوم حذف شده است. این انتقال نشان دهندهی کاهش گروهای اکسیژن دار ایجاد شده در صفحات گرافنی و کاهش موفقیت آمیز اکسید گرافن است. انتقال قله ۲۴۰ nm در نمونههای RGO 900 – MN، H – RGO و RGO 300 MW به ترتیب در ۳۱۰، ۲۶۰ و ۲۴۰ است. بیشترین مقدار مربوط به نمونه ی MW - RGO 300 – MM به ترتیب در ۳۱۰، ۲۶۰ و main ۲۴۵ است. بیشترین مقدار مربوط به نمونه ی آروماتیک کربن نسبت به دیگر نمونهها است [۸و۱۲].



#### Wavelength (nm)

شکل ۴ – ۲۴ : طیف مادون قرمز RGO – H

۴-۷-۴ الگوی پراش پر تو ایکس

در آنالیز XRD اکسید گرافن کاهش یافته یک قله بزرگ در زاویه حدود ۲۴/۷۶<sup>o</sup> مشاهد شده است. همانطور که در شکل ۴–۲۵ مشاهده میشود در اکسید گرافن کاهش یافته شیمیایی قله مربوط به اکسید گرافن دیده نمیشود، که نشان دهندهی حذف گروههای اکسیژندار و تشکیل اکسید گرافن کاهش یافته و لایه بهلایه شدن نانو ورقه های دو بعدی گرافن است [۱۷].



شکل ۴ – ۲۵ :پراش پرتو ایکس اکسید گرافن کاهش یافته به روش شیمیایی

۴-۷-۵- ریخت شناسی

در شکل ۴–۲۶ نانو ورقههای دو بعدی اکسید گرافن کاهش یافته با روش شیمیایی در مقایسهای مختلف نشان داده شده است.



شکل ۴ –۲۶ : تصاویر ریخت شناسی نمونه GO - H تصاویر ریخت شناسی نمونه GO در مقایس-های الف)۲۲۳ ب)۲۰۰ nm ج)۲۰۰ nm های الف)۲۴۳

## EDX - ۶-۷-۴ طيف نگار

شکل ۴–۲۷ طیف EDX نمونهی RGO – H را نشان میدهد. همانطور که انتظار بود نسبت اکسیژن ها نسبت به GO کاهش یافته است. در این نمونه نسبت وزنی عنصر کربن به اکسیژن برابر با ۲/۹۴ و نسبت اتمی ۳/۹۲ است. نتایج حاصل بخش ۴–۷–۶ نشان میدهد که، نسبت درصدهای وزنی و اتمی نمونهی اتمی RGO ۲۹۲ است. به نمونهی MW – RGO 300 – MW کمتر داشته است.



شكل FDAX : آناليز EDAX نمونه RGO – H سنتز شده

# ۴–۸– سنتز کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دی سولفید مولیبدن

روش سنتز اجرا شده بر مبنای پژوهش ژوان لی و همکارانش انجام شد [۲۰]. همانطور که در شکل ۴-۲۸ نشان داده شده است با استفاده از روش گرما آبی ابتدا ۳g ۴۰ اکسید گرافن به ۴۰ml آب مقطر ۲ بار تقطیر شده اضافه شد و برای مدت ۳۰ دقیقه در التراسونیک قرار گرفت. محلول دیگری حاوی ۲۱۱g/ . آمونیوم هپتا مولیبدات تترا هیدرات و ۰/۱۸۲g تیوره در ۳۱ ۲۰ آب دوبار تقطیر شده تهیه گردید که به مدت ۱ ساعت بروی همزن قرار گرفت.

محلول دوم به آرامی به محلول اول اضافه شد و به مدت ۳۰ دقیق در التراسونیک قرار گرفت. محلول حاصل به داخل تفلون انتقال داده شد و در راکتور در دمای<sup>0</sup> ۲۰۰ برای مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت.

محصول نهایی توسط آب شستشو شد ودر دمای C<sup>o</sup> ۶۰ برای مدت ۱۰ ساعت خشک گردید [۲۰]. نمونه بدست امده در این مرحله را با RGO – MoS<sub>2</sub> نامگذاری شد.



شکل ۴ –۲۸ : طرحوارهی از سنتز کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دیسولفید مولیبدن با استفاده از روش هیدرترمال

۴-۹- مشخصه یابی کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دیسولفید مولیبدن

۴-۹-۱- طیف نگار رامان کامپوزیت ( RGO - MoS2)

شکل ۴–۲۹ الگوی طیف رامان نمونهی کامپوزیت RGO - MoS2 را نشانمیدهد. قلههای ۱۳۵۰ مربوط به نوار D و D مربوط به نوار G در اکسید گرافن کاهش یافته است که نسبت شدت آنها برابر با ۱/۲۶ است که در مقایسه با GO افزایش داشته است.



همچنین در مقایسه با نمونههای RGO – H و MW – RGO 300 نیز افزایش داشته است.



شکل ۴- ۲۹ : الگوی طیف رامان نمونهی کامپوزیت RGO - MoS2 سنتز شده در این پایان نامه با استفاده از روش هیدروترمال

قلههای ۲۸۰و ۲۵۵و <sup>I-I</sup> ۴۶۰ cm به ترتیب مربوط به مدهای E2g ، E1g و E1g برای ساختارهای شش وجهی دیسولفید مولیبدن (2H – MoS2) است [۲۰]. قلههای ۳۳۳، ۲۷۳ و<sup>I-I</sup> Cm نشان دهندهی فاز ثانویه T1 از MoS2 است که توسط رامان قابل تشخیص است. حضور MOS2 میتواند منجر به خواص کاتالیزور بهتر شود[۳۷].

قله واقع در <sup>1</sup> ۹۹۴ cm<sup>-1</sup> میتواند به حالت کششی اکسیژن واقع در نوک هشتوجهی MoO<sub>6</sub> فلام واقع در امتداد محور b میتواند به حالت کششی اکسیژن واقع در امتداد محور b میتواند به حالت کشته وجهی های MoO<sub>6</sub> به اشتراک گذاشته (Mo<sup>6+</sup>=O) در امتداد محور b میتواند محور MoO<sub>3</sub> چند لایه نسبتا ضعیف است. قله واقع شده در <sup>1</sup> ۸۱۵ cm<sup>-1</sup> نشده، نسبت داده شود. این قله برای MoO<sub>3</sub> چند لایه نسبتا ضعیف است. قله واقع شده در است داده محور a این واقع در این واقع در این واقع در این واقع در این واقع شده در این میتراک گذاشته در در در در معین است. قله واقع شده در این قله برای در دو این واقع شده در این واقع شده در این واقع در بین دو ایم MoO همسایه (O–Mo–O) در امتداد محور a اختصاص داده میشود که از به اشتراک گذاری گوشهای اکسیژن مشترک در دو هشت وجهی نتیجه میشود. این

قله برای MoO<sub>3</sub> چند لایه نسبتا قوی است [۳۹و۳۹]. قله واقع شده در MoO<sub>3</sub> جه حالت کششی اکسیژن واقع در بین سه اتم Mo همسایه (O–Mo–O) نسبت داده می شود [۴۰] که به علت اکسید شدن بخشهای از MoS<sub>2</sub> زمانیکه در معرض هوا قرار گرفته اند، ایجاد شدند [۱۵]. وجود قلههای مربوط به RGO و MoS<sub>2</sub> در رامان نشان دهندهی سنتز کامپوزیت RGO - MoS است.

## RGO - MoS2 ویژگی های اپتیکی UV-vis کامپوزیت

در شکل ۴–۳۰ طیف جذب نمونهها حاصل از دستگاه طیف سنج نوری UV نشان داده شه است. در نمونه RGO - MoS2 قله جذب ۲۴۰nm به ۳۰۸nm منتقل شده است که نشان دهندهی کاهش اکسید گرافن میباشد.



شکل ۴ - ۳۰ : طیف جذب نمونههای مختلف سنتز شده ۲ (۳ RGO - H(۲ GO (۱ GO - H) RGO - MoS2 (۳ RGO - H) RGO - ۲ (۲ GO (۱

MW – RGO 900(å MW - RGO 300(\*

۴-۹-۵- ریخت شناسی کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دی سولفید مولیبدن

شکل ۴–۳۱ تصاویر ریخت شناسی کامپوزیت RGO - MoS2 را در مقیاسهای مختلف نشان میدهد. همانطور که در مشاهده میشود، نانو گلهای MoS2 که بصورت کرههای تو خالی هستند بروی صفحات RGO قرار گرفتهاند [۲۰].



شکل ۴-۳۱ : ریخت شناسی نمونه RGO - MoS2 در مقیاس ۲۰۰ nm، ۵۰µm، ۲µm و ۲۰۰ nm

۴−۸−طیف نگار EDX

در شکل ۴–۳۲ آنالیز EDAX نمونه کامپوزیت MoS2 - MoS2 نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عنصر اصلی کربن و مولیبدن میباشد. نسبت درصد وزنی C به O برابر ۳/۱۶ و نسبت درصد اتمی ۴/۲۲ است. همچنین نسبت وزنی Mo به S برابر ۱/۸ و نسبت درصد اتمی ۱/۶۲ است [۴۰].



شکل ۴- ۳۲ : آنالیز EDAX نمونهیRGO - MoS2 سنتز شده با روش هیدروترمال

# RGO – MoS<sub>2</sub> حسگری گازی -۹-۴

نمودار تغییرات مقاومت برحسب زمان برای نمونهی RGO – MoS<sub>2</sub> برای غلظتهای ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، نمودار تغییرات مقاومت برحسب زمان برای نمونهی ۱۰۰۵ در شکل ۴–۳۳ و ۴–۳۴ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود در هر دو دما با افزایش غلظت گاز، حساسیت افزایش می یابد. حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونه در دو دما در جدول ۴–۹ و ۵–۹ نشان داده شده است. با در معرض قرار دادن ناحیه سطحی حسگر به گاز آمونیاک در دمای C °۱۰۰، با افزایش غلظت گاز از ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ پاسخ گاز به ترتیب از ۱۴/۶۰ ٪ به ۲۰/۵۹ ٪ افزایش یافته است. در دمای اتاق با افزایش غلظت پاسخ گاز به ترتیب از ۱۴/۶۰ ٪ به ۲۰/۵۰ ٪ افزایش یافته است.





جدول ۴ –۹ : تغییرات مقاومت، حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونهی RGO – MOS2 نسبت به غلظتهای مختلف گاز NH3 در دمای اتاق

RGO - MoS2	تغيرات مقاومت(ohm)	حساسيت(%)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی(S)
۱۰۰ppm	۴/۰	۲/۲	270	887
۲۰۰ppm	۵/ ۰	٣/٣	۳۷۵	188
۵۰۰ppm	۶/۰	۵/۳	۶۵۸	٧٠٢
۱۰۰۰ppm	٧/•	۴	۶۱۹	741
۱۵۰۰ppm	٩/٠	١/۵	۵۳۶	١٢٣٨



شکل ۵ -۳۴ : نمودار تغییرات مقاومت برحسب زمان نمونهی RGO – MOS2 سنتز شده نسبت به گاز NH3 در دمای ۱۰۰c برای غلظتهای ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ppm

مختلف گاز NH3 در دمای ۱۰۰c					
RGO - MoS2	تغيرات مقاومت(ohm)	حساسيت(%)	زمان پاسخ (S)	زمان بازیابی(S)	
۱۰۰ppm	١/٢	14/80	220	1117	
۲۰۰ppm	۲/۴۸	<b>TY/1Y</b>	۳۸۳	٩۶۵	
۵۰۰ppm	۴/٣	۴۸/۷۷	198	1747	
۱۰۰۰ppm	۶/۲۴	۷۰/۴۵	2048	971	
۱۵۰۰ppm	V/V	V•/۵•	1848	١٨۵٢	

جدول ۵ – ۹ : تغییرات مقاومت، حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی نمونهی RGO – MOS2 نسبت به غلظتهای مختلف گاز NH3 در دمای ۱۰۰c

در شکل ۴-۳۶ نمودار تغییرات حساسیت با افزایش غلظت نمونهی RGO@MoS<sub>2</sub> در دمای اتاق و ۱۰۰C را نشان میدهد. با افزایش غلطت از ۱۰۰ تا ppm۱۵۰۰ سطح بزرگتری توسط مولکولهای گاز جذب شده است و واکنشهای سطحی بر روی لایه حسگر افزایش یافته و در نتیجه پاسخ نسبت به گاز هدف افزایش مییابد



شکل ۴-۳۵ : نمودار تغییرات حساسیت با افزایش غلظت نمونهی RGO@MoS2 الف) در دمای اتاق ب) در دمای ۲۰۰

#### ۴-۹- جمعبندی

در این فصل با استفاده از روش هامرز بهبود یافته اکسید گرافن سنتز شد. سپس با دو روش کاهش حرارتی و شیمیایی اکسید گرافن کاهش یافته تهیه گردید. در روش حرارتی ابتدا اکسید گرافن لایه لایه سنتز شده و سپس تحت دمای بالا در خلا کاهش یافت و با استفاده از ماکرویوو عملیات کاهش بهبود داده شد. در روش شیمیایی با استفاده از هیدرازین هیدرات به عنوان مادهی کاهنده فرآیند کاهش با عملیات رفلاکس انجام گرفت. با استفاده از روش هیدروترمال کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته با دی سولفید مولیبدن تهیه شد. با استفاده از دستگاههای آنالیز مشخصهیابی نمونهها صورت گرفت. همچنین حسگری گازی نمونهها در دمای اتاق و دمای ۲۰۰۲ برای گاز آمونیاک در غلظتهای مختلف انجام شد.
فس

بنايج ويشهادات

### ۵–۱– نتیجه گیری

مشخصه یابی FT-IR فرآیند تبدیل شدن گرافیت به اکسیدگرافن در فرآیند اکسایش و در نهایت به اکسید گرافن کاهش یافته و از بین رفتن گروههای اکسیژن دار بعد از فرآیند کاهش نشان میدهد. در نمونه MW- RGO 900 و MW- RGO کاهش نیست به MW- RGO 300 و H - RGO کاهش بیشتر داشته است که نشان دهندهی حدف بیشتر گروههای اکسیژن دار مانند OH در طی فرآیتد کاهش است. تغییرات نسبت شدت دو قله در طیف رامان نشان دهندهی تبدیل اکسید گرافن به اکسید گرافن کاهش یافته بیشتر است. مقایسه نسیت شدت قلهها در آنالیز رامان برای نمونههای کاهش یافته دریافتیم کاهش یافته بیشتر است. مقایسه نسیت شدت قلهها در آنالیز رامان برای نمونههای کاهش یافته دریافتیم که به ترتیب شدت قلهها به ترتیب در روش هیدرازین سپس در 900 MW- RGO و در نهایت در MW- RGO 300 و در نهایت در MW- RGO 300 و در نهایت در MW- RGO 300 را نشان داد. در دمای اتاق دریافتیم که تمام نمونهها مقاومتی در حد اهم از خود نشان میدهند. در مقایسه دو نمونه حاصل از روش کاهش حرارتی، در بررسی اثر دما بر روند کاهش، دریافتیم که دما باعث افزایش رسانندگی نانو ورقههای گرافنی میباشد. خصوصیات گرافنی در نمونه های کاهش حرارتی با افزایش دما افزایش یافت. در ریخت شناسی نمونه ها نانو صفحات دو بعدی مچاله شده برای تمامی نمونهها مشاهد می شود. در آنالیز پراش پرتو ایکس به وضوح روند افزایش فاصله نانو ورقههای گرافنی از یکدیگر نشان داده شده است.

حسگر گازی نمونه اکسید گرافن کاهش یافته در دمای C °۹۰۰ به علت داشتن رسانندگی بیشتر نسبت به دو نمونه کاهش یافته دیگر و نانو کامپوزیت اکسید گرافن و دی سولفید مولیبدن مورد بررسی قرار گرفت. حسگری با گاز هدف آمونیاک برای غلظت های مختلف از ۲۰۰ppm تا ۱۵۰۰pph در دمای اتاق و دمای C °۱۰۰ ارزیابی شد. حساسیت حاصل از حسگری اکسید گرافن کاهش یافته در دمای ° ۹۰۰C، در دمای C °۱۰۰ نسبت به دمای اتاق بیشتر بود.

از نتایج حاصل از حسگری، نمونه ها تحت دما حساسیت بیشتری نسبت به گاز هدف از خود نشان دادند. همچنین نمونه کامپوزیت حساسیت و پاسخ بهتری نسبت به نمونه اکسید گرافن کاهش یافته داشته است.

#### ۲-۵- پیشنهادات

- ۱- اکسید گرافن با روش های دیگر هامرز جهت صرفه جویی در زمان و انرژی تهیه گردد.
- ۲- جهت کاهش اکسید گرافن تهیه شده از روش هامرز از عوامل کاهش دهنده سبز مانند ویتامینC و غیره استفاده گردد. این مواد بر خلاف هیدرازین هیدرات که در این پژوهش مورد

استفاده قرار گرفت تولید مواد سمی نمیکنند و برای محیط زیست ضرری در پی ندارد.

- ۳- تهیه کامپوزیت اکسید گرافن کاهش یافته و دی سولفید مولیبدن با استفاده از اکسید گرافن
  کاهش یافته و مقایسه حسگری آن با کامپوزیتی که در این پژهش تهیه شده است.
- ۴- خواص آنتی باکتریال اکسید گرافن کاهش یافته حرارتی و شیمیایی و همچنین نانو کامپوزیت
  تهیه شده بررسی شود.

۵- با توجه به حسگری اکسید گرافن کاهش یافته و همچنین پلیمرها در دمای اتاق سنتز کامپوزیت
 های پلیمری برمبنای گرافن جهت کاربرد حسگرگازی در دمای اتاق موفقیت امیز خواهد بود.

- [1] N. Martin and J.-F. Nierengarten, *Supramolecular chemistry of fullerenes and carbon nanotubes*: John Wiley & Sons, 2012.
- [Y] T. Wezeman, K. S. Masters, and S. Bräse, "Double trouble—the art of synthesis of chiral dimeric natural products," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 53, pp. 4524-4526, 2014.
- [٣] W. Choi, I. Lahiri, R. Seelaboyina, and Y. S. Kang, "Synthesis of graphene and its applications: a review," *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*, vol. 35, pp. 52-71, 2010.
- [\*] J. Zhao, L. Liu, and F. Li, Graphene oxide: physics and applications vol. 1: Springer, 2015.
- [ $\Delta$ ] C. K. Chua and M. Pumera, "Chemical reduction of graphene oxide: a synthetic chemistry viewpoint," *Chemical Society Reviews*, vol. 43, pp. 291-312, 2014.
- [۶] K. De Silva, H.-H. Huang, R. Joshi, and M. Yoshimura, "Chemical reduction of graphene oxide using green reductants," *Carbon*, vol. 119, pp. 190-199, 2017.
- [v] M. Sajibul, A. Bhuyan, M. N. Uddin, M. M. Islam, F. A. Bipasha, and S. S. Hossain, "Synthesis of graphene," *International Nano Letters*, vol. 6, p. 65, 2016.
- [A] V. B. Mohan, K.-t. Lau, D. Hui, and D. Bhattacharyya, "Graphene-based materials and their composites: a review on production, applications and product limitations," *Composites Part B: Engineering*, vol. 142, pp. 200-220, 2018.
- [9] X. Wu, Y. Xing, D. Pierce, and J. X. Zhao, "One-pot synthesis of reduced graphene oxide/metal (oxide) composites," ACS applied materials & interfaces, vol. 9, pp. 37962-37971, 2017.
- [1.] M. Landmann, E. Rauls, and W. Schmidt, "The electronic structure and optical response of rutile, anatase and brookite TiO2," *Journal of physics: condensed matter*, vol. 24, p. 195503, 2012.
- [11] M. De, S. S. Chou, and V. P. Dravid, "Graphene oxide as an enzyme inhibitor: modulation of activity of α-chymotrypsin," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 133, pp. 17524-17527, 2011.
- [17] G. Eranna, B. Joshi, D. Runthala, and R. Gupta, "Oxide materials for development of integrated gas sensors—a comprehensive review," *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*, vol. 29, pp. 111-188, 2004.
- [1٣] H. Nian, J. Wang, H. Wu, J.-G. Lo, K.-H. Chiu, J. G. Pounds, *et al.*, "Electrochemical immunoassay of cotinine in serum based on nanoparticle probe and immunochromatographic strip "*Analytica chimica acta*, vol. 713, pp. 50-55, 2012.

- [14] D. C. Marcano, D. V. Kosynkin, J. M. Berlin, A. Sinitskii, Z. Sun, A. Slesarev, *et al.*, "Improved synthesis of graphene oxide," *ACS nano*, vol. 4, pp. 4806-4814, 2010.
- [16] A. Venkatesan, S. Rathi, I.-y. Lee, J. Park, D. Lim, M. Kang, et al., "Molybdenum disulfide nanoparticles decorated reduced graphene oxide: highly sensitive and selective hydrogen sensor," *Nanotechnology*, vol. 28, p. 365501, 2017.
- [19] S. N. Alam, N. Sharma, and L. Kumar, "Synthesis of graphene oxide (GO) by modified hummers method and its thermal reduction to obtain reduced graphene oxide (rGO)," *Graphene*, vol. 6, pp. 1-18, 2017.
- [1Y] M. Aslam, M. Kalyar, and Z. Raza, "Synthesis and structural characterization of separate graphene oxide and reduced graphene oxide nanosheets," *Materials Research Express*, vol. 3, p. 105036, 2016.
- [1A] H. Saleem, M. Haneef, and H. Y. Abbasi, "Synthesis route of reduced graphene oxide via thermal reduction of chemically exfoliated graphene oxide ",*Materials Chemistry and Physics*, vol. 204, pp. 1-7, 2018.
- [Y•] X. Li, C. Zhang, S. Xin, Z. Yang, Y. Li, D. Zhang, et al., "Facile synthesis of MoS2/reduced graphene oxide@ polyaniline for high-performance supercapacitors," ACS applied materials & interfaces, vol. 8, pp. 21373-21380, 2016.
- [Y1] W. Shi ,S. Song, and H. Zhang, "Hydrothermal synthetic strategies of inorganic semiconducting nanostructures," *Chemical Society Reviews*, vol. 42, pp. 5714-5743, 2013.
- [YY] B. M. Tissue, "Ultraviolet and visible absorption spectroscopy," *Characterization of Materials*, pp. 1-13, 2002.
  - [YY]Elton N.Kaufmann, (2003), Charactrization of Maerial, John Wiley & Sons, INC.
- [۲۴] کریشنر. هه، ۱۳۷۰، **شناسایی مواد به کمک اشعه ایکس**،عباس طائب، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
- [Ya] B. Fultz and J. M. Howe, *Transmission electron microscopy and diffractometry of materials*: Springer Science & Business Media, 2012.
- [Y9] U. Alver, T. Kılınç, E. Bacaksız, T. Küçükömeroğlu, S. Nezir, I. Mutlu, *et al.*, "Synthesis and characterization of spray pyrolysis Zinc Oxide microrods," *Thin Solid Films*, vol. 515, pp. 3448-3451, 2007.
- [YY] A. A. Sagade and R. Sharma, "Copper sulphide (CuxS) as an ammonia gas sensor working at room temperature," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 133, pp. 135-143, 2008.

- [YA] J. I. Goldstein, D. E. Newbury, P. Echlin, D. C. Joy, C. E. Lyman, E. Lifshin, et al., "Generation of X-rays in the SEM specimen," in Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, ed: Springer, 2003, pp. 271-29.9
- [Y9] P. Vandenabeele, Practical Raman spectroscopy: an introduction: Wiley Online Library, 2013.
- [r.] Y.-F. Sun, S.-B. Liu, F.-L. Meng, J.-Y. Liu, Z. Jin, L.-T. Kong, *et al.*, "Metal oxide nanostructures and their gas sensing properties: a review," *Sensors*, vol. 12, pp. 2610-2631, 2012.
- [٣1] C. Wang, L. Yin, L. Zhang, D. Xiang, and R. Gao, "Metal oxide gas sensors: sensitivity and influencing factors," *Sensors*, vol. 10, pp. 2088-2106, 2010.
- [٣٢] N. Cao and Y. Zhang, "Study of reduced graphene oxide preparation by Hummers' method and related characterization," *Journal of Nanomaterials*, vol. 2015, p. 2, 2015.
- [٣٣] D. Voiry, J. Yang, J. Kupferberg, R. Fullon, C. Lee, H. Y. Jeong, *et al.*, "Highquality graphene via microwave reduction of solution-exfoliated graphene oxide," *Science*, vol. 353, pp. 1413-1416, 2016.
- [٣۴] W.-S. Jiang, C. Yang, G.-X. Chen, X.-Q. Yan, S.-N. Chen, B.-W. Su, *et al.*,
  "Preparation of high-quality graphene using triggered microwave reduction under an air atmosphere," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 6, pp. 1829-1835, 2018.
- [٣۵] A. Mane and A. Moholkar, "Orthorhombic MoO3 nanobelts based NO2 gas sensor," *Applied Surface Science*, vol. 405, pp. 427-440, 2017.
- [٣۶] X. Zhao, X. Ma, Q. Lu, Q. Li, C. Han, Z. Xing, *et al.*, "FeS2-doped MoS2 nanoflower with the dominant 1T-MoS2 phase as an excellent electrocatalyst for high-performance hydrogen evolution," *Electrochimica Acta*, vol. 249, pp. 72-78, 2017.
- [٣٧] K. Eda, "Raman spectra of hydrogen molybdenum bronze, H0. 30MoO3," *Journal of Solid State Chemistry*, vol. 98, pp. 350-357, 1992.
- [٣٩] T. He and J. Yao, "Photochromism of molybdenum oxide," Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, vol. 4, pp. 125-143, 2003.
- [\*•] K. Chang and W. Chen, "L-cysteine-assisted synthesis of layered MoS2/graphene composites with excellent electrochemical performances for lithium ion batteries," ACS nano, vol. 5, pp. 4720-4728, 2011.

#### Abstract

Two-dimensional transition metal dichalcogenides (2D TMDs) are a family of materials consisting of over 40 compounds with the generalized formula of MX<sub>2</sub>. In the bulk form, MX<sub>2</sub> compounds are layered materials (van der Waals solids) in which there is strong intralayer bonding and weak interlayer bonding. After the synthesis of graphene, in the first year of this century, a wide research field on two-dimensional materials opens. In this thesis, graphene oxide, thermally reduced graphene oxide, chemically reduced graphene oxide, and molybdenum sulfide/reduced graphene oxide Nano-composites were

synthesized and characterized. Their gas sensing properties were disused. The structural properties, elemental composition, surface morphology of the synthesized samples were studied by XRD, FT-IR, RAMAN, EDAX, FE-SEM and UV-vis analysis methods, respectively. In this research, Grapheme oxide (GO) was produced via modified Hammer method using graphite powder and potassium permanganate (KMno4). Graphene oxide results from the breakdown of weak van der walls bonds between two-dimensional graphite layers. In this process, functional groups are formed between the plates. In order to reduce the graphene oxide Chemical reduction and thermal reduction at 300, 900 °C was used. Then thermal reduction sample was improved via microwave method. Also Molybdenum sulfide/reduced graphene oxide composite was prepared by hydrothermal method. In Raman analysis, changes in the intensity ratio of the twin RGO peaks relative to the GO indicate a successful and excellent reduction using this method. The results of the infrared spectrometry show a decrease in the intensity of the peaks of the oxygenated groups and the oxidation process. The microscopic images of the samples also show the two-dimensional structure of the RGO crumpled sheets and molybdenum disulfide Nanoflower. Graphene oxide is an insulating material that exhibit excellent conductivity after reduction process. The synthesized composite sensor showed better sensitivity compare with the reduced graphene oxide sensor at room temperature and  $100 \degree C$ .

**Keywords:** Hummers method, Reduced Graphene Oxide Nanocomposite / Molybdenum Disulfide, Gas Sensor



# Faculty of physics and Nuclear Engineering

MSC Thesis in Nanophysics

# Synthesis, characterization and investigating physical

### properties of graphene nano-composites

By: Mahdie Mehrabifar

Supervisor:

Dr. Mohammad Bagher Rahmani

September 2019